

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

is not more than 1.0 degree; and in the range of a distance of 10-100% from the first surface, the angle of the side surface falls within the range of -7 to -15 degrees, and the difference between the inclination angle of the left side surface and the inclination angle of the right side surface is not more than 1.0 degree.

(57) 要約: 本発明では、貫通孔の側面が平滑であり、高い信頼性を兼ね備えた貫通電極を得ることができる技術を提供することを目的とする。本発明のガラス基板の一つは、第一面と第二面を有し、前記第一面から前記第二面まで貫通する少なくとも1つの貫通孔を備えるガラス基板であって、前記貫通孔の側面は、前記第一面から距離0%以上10%未満の範囲において、側面の角度は4°以上7°以下の範囲となり、断面視において、前記貫通孔の側面を左側面および右側面とした場合、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が1.0°以下であり、前記第一面から距離10%以上距離100%以下の範囲において、側面の角度は-7°以上-15°以下の範囲となり、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が1.0°以下となる。

明 細 書

発明の名称：

ガラス基板、多層配線基板、およびガラス基板の製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、ガラス基板、多層配線基板、およびガラス基板の製造方法に関する。

背景技術

[0002] 近年、回路基板を積層した三次元実装技術が用いられている。このような実装技術においては、回路基板に貫通電極を形成することが行われる。貫通電極は、絶縁体で構成された基板に貫通孔を形成し、この貫通孔に導電体を配置することによって形成される。回路基板の高集積化に伴い、貫通孔についても更なる微細化が必要となる。

[0003] 例えば、特許文献1は、板状ガラスにエキシマレーザ光を照射して複数の貫通孔を有するガラス基板を提供する技術を開示している。特許文献2は、UVレーザビームによってガラス品の前面を照射する工程を含む、ガラスに孔の高密度アレイを作製する方法を開示する。また、特許文献3は、貫通孔を含む基板と、前記貫通孔の内側面に沿って配置された導電体と、を備え、前記貫通孔は、前記第1面から前記第2面までの区間のうち前記第1面から6.25%、18.75%、31.25%、43.75%、56.25%、68.75%、81.25%、93.75%の距離の位置における前記貫通孔の中心軸に対する内側面の傾斜角度（前記第1面側が拡がる角度を正の傾斜角度とする）の合計値が、8.0°以上である条件を満たす貫通孔の形状を開示する。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：国際公開第2010/087483号

特許文献2：特表2014-501686号公報

特許文献3：特許第6809511号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、特許文献1から3に記載された内容で貫通孔は、貫通孔の側面粗さによる、貫通電極の伝送特性への影響については、検討されていない。このため、特許文献1から3に記載された貫通孔の側面は、側面の分散粗さは1,000nm以上となり、PV (Peak to Valley) は1,500nm以上となっている。このため、特に、5Gに用いられる周波数帯の内、サブ6GHz帯といった高周波数帯では、貫通孔側面の粗さが原因となり、貫通電極の伝送特性を十分良好に保つことが難しい。

[0006] また、ガラス基板上に配線層を形成し、これらを接続する貫通電極を形成した場合、ガラスのCTE (COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION、熱膨張率) と配線や貫通電極の材料となるCu等のCTEが異なるため、熱応力の影響が懸念される。このため、デバイスの信頼性を評価するための信頼性試験の一つとして加速試験のTCT (Thermal Cycle Test) を実施される。

しかし、従来技術においては、熱応力に対する貫通電極の信頼性を高めるための貫通孔御形状について、十分に検討がされていないことから、貫通電極と配線層の界面で配線層が破断することが確認されている

[0007] そこで、本発明では、良好な伝送特性および高い信頼性を備えた貫通電極を形成することが可能なガラス基板およびそのようなガラス基板を備えた多層配線基板を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0008] 上記の課題を解決するために、代表的な本発明のガラス基板の一つは、第一面と第二面を有し、前記第一面から前記第二面まで貫通する少なくとも1つの貫通孔を備えるガラス基板であって、前記貫通孔の側面は、前記第一面から距離0%以上10%未満の範囲において、側面の角度は4°以上7°以下の範囲となり、断面視において、前記貫通孔の側面を左側面および右側面とした場合、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が1.0°以下であ

り、前記第一面から距離 10%以上 100%以下の範囲において、側面の角度は -7° 以上 -15° 以下の範囲となり、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が 1.0° 以下となる。

発明の効果

[0009] 本発明によれば、良好な伝送特性および高い信頼性を備えた貫通電極を形成することが可能なガラス基板およびそのようなガラス基板を備えた多層配線基板を提供することが可能となる。

上記した以外の課題、構成および効果は、以下の発明を実施するための形態における説明により明らかにされる。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]図1は、円錐台形状の貫通孔の断面および傾斜角度の測定方法を示す図である。

[図2]図2は、貫通孔の側面粗さの測定方法を示す図である。

[図3]図3は、第一実施形態における実施例1の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図4]図4は、第一実施形態における実施例2の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図5]図5は、第一実施形態における実施例3の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図6]図6は、第一実施形態における比較例1の貫通孔の断面形状を示す図である。

[図7]図7は、第一実施形態における比較例1の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図8]図8は、第一実施形態における比較例2の貫通孔の断面形状を示す図である。

[図9]図9は、第一実施形態における比較例2の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図10]図10は、第一実施形態における比較例3の貫通孔の断面形状を示す

図である。

[図11]図 1 1 は、第一実施形態における比較例 3 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図12]図 1 2 は、応用例 1 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図13]図 1 3 は、応用例 2 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図14]図 1 4 は、応用例 3 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[図15A]図 1 5 A は、表 5 をグラフにして示す図である。

[図15B]図 1 5 B は、貫通電極を形成した場合を示す模式的に示す図である。

[図15C]図 1 5 C は、本開示において形成される貫通孔および貫通電極の特徴を説明する図である。

[図16A]図 1 6 A は、第一実施形態における各実施例および各比較例の貫通孔の典型的な断面形状の S E M 画像を示す図である。

[図16B]図 1 6 B は、第一実施形態における各実施例および各比較例の貫通孔の断面の S E M 画像を示す図である。

[図16C]図 1 6 C は、第一実施形態における各実施例の貫通孔の稜線を説明する図である。

[図16D]図 1 6 D は、第一実施形態における貫通孔に貫通電極を形成した場合を示す図である。

[図17]図 1 7 は、第一実施形態における実施例 1 の貫通電極の伝送特性と、比較例 1 の貫通電極の伝送特性を示す図である。

[図18]図 1 8 は、第一実施形態における多層配線基板の構成の一例を示す図である。

[図19]図 1 9 は、第一実施形態における多層配線基板の構成の他の例を示す図である。

[図20]図 2 0 は、ガラス基板を第一支持体に張り合わせる工程を示す図である。

[図21]図 2 1 は、レーザ改質部を形成する工程を示す図である。

[図22]図 2 2 は、第一配線層を形成する工程を示す図である。

[図23]図23は、第二支持体を接着する工程を示す図である。

[図24]図24は、第一支持体を剥離する工程を示す図である。

[図25]図25は、貫通孔を形成する工程を示す図である。

[図26]図26は、貫通電極を形成する工程を示す図である。

[図27]図27は、絶縁樹脂層を形成する工程を示す図である。

[図28]図28は、第二支持体および第二接着層を剥離する工程を示す図である。

[図29]図29は、第一配線層および第二配線層を形成する工程を示す図である。

[図30]図30は、半導体素子とBGA基板のインターポーザ基板として、多層配線基板を用いる場合を示す図である。

[図31]図31は、図30の場合の断面を示す図である。

[図32]図32は、通信用の電子デバイスに多層配線基板および半導体素子が用いられる場合を示す図である。

[図33]図33は、図32の場合の断面を示す図である。

発明を実施するための形態

[0011] 本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態及び実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、本開示における実施形態及び実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態及び実施例の構成の一部を他の実施形態及び実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態及び実施例の構成に他の実施形態及び実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施形態及び実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。

さらに、本発明が目的とするものと均等な効果をもたらす全ての実施形態をも含むものである。

[0012] 図面において示す各構成要素の位置、大きさ、形状、範囲なども、発明の

理解を容易にするため、実際の位置、大きさ、形状、範囲などを表していない場合がある。このため、本発明は、必ずしも、図面に開示された位置、大きさ、形状、範囲などに限定されない。

[0013] なお、本開示において、「面」とは、板状部材の面のみならず、板状部材に含まれる層について、板状部材の面と略平行な層の界面も指すことがある。また、「上面」、「下面」とは、板状部材や板状部材に含まれる層を図示した場合の、図面上の上方又は下方に示される面を意味する。なお、「上面」、「下面」については、「第一面」、「第二面」と称することもある。

[0014] また、「側面」とは、板状部材や板状部材に含まれる層における面や層の厚みの部分を意味する。さらに、面の一部及び側面を合わせて「端部」ということがある。

また、「貫通孔の側面」とは、物体に設けられた貫通孔について、貫通孔を形成している物体上の界面を意味する。

また、「上方」とは、板状部材又は層を水平に載置した場合の垂直上方の方向を意味する。さらに、「上方」及びこれと反対の「下方」については、これらを「Z軸プラス方向」、「Z軸マイナス方向」ということがあり、水平方向については、「X軸方向」、「Y軸方向」ということがある。

[0015] さらに、Z軸方向の距離を「高さ」と称し、X軸方向とY軸方向で規定されるXY平面上の距離を「幅」と称する。また、層状の物体に対して高さを言う場合、「厚み」とも称する。

また、「ガラス基板に設けた貫通電極」とは、ガラス基板を多層配線基板の一部として用いる場合に、ガラス基板の第1面及び第二面を電氣的に導通するために設けた導電経路を意味し、必ずしも、ガラス基板を単一の導電材料で完全に貫通している必要はない。第1面からの導電通路と第二面からの導電通路が接続されていれば、貫通電極に含まれる。さらに、貫通電極の形態は、貫通孔（有底のものも、完全な貫通のものも、いずれの形態をも含む）を導電材料で埋め込んだフィルド型でもよいし、貫通孔の側壁部分のみを導電材料で覆ったコンフォーマルのいずれをも含む。

[0016] また、「平面形状」、「平面視」とは、上方から面又は層を視認した場合の形状を意味する。さらに、「断面形状」、「断面視」とは、板状部材又は層を特定の方向で切断した場合の水平方向から視認した場合の形状を意味する。

さらに、「中心部」とは、面又は層の周辺部ではない中心部を意味する。そして、「中心方向」とは、面又は層の周辺部から面又は層の平面形状における中心に向かう方向を意味する。

[0017] <測定方法>

本発明の第一実施形態に係るガラス基板に設けた貫通孔の形状を説明するために、まず、貫通孔12の傾斜角度の測定方法、側面粗さの測定方法を以下に示す。

[0018] ここで、ガラス基板貫通孔の側壁の位置による傾斜角を測定し、その値を記述するにあたっての注意点を示す。

貫通孔における特定の位置を、ガラス基板の片面からの深さ方向の位置で指定した場合、その位置での側面の角度は、その位置での側面表面の形状をどの程度のスケールにて観察するか大きく依存する。

つまり、ガラス基板の貫通孔全体を俯瞰するようなスケールにて、側壁のある位置での側壁の傾斜角を観察した場合と、測定点付近の側壁を拡大し、その位置での側壁の微小な凹凸が明瞭となり、角度を指定した点が、その凹凸のどこに相当するかを厳密に判定して、その位置での接線の傾斜角をもって、目的の角度とする場合とでは、結果が大きく異なる可能性がある。

本開示におけるガラス基板貫通孔の傾斜角とは、前者にあたるものであり、側面表面の凹凸に過度に影響されることなく、貫通孔全体を俯瞰的に見た場合の傾向を反映した傾斜角を意味する。

測定法の一例として、貫通孔全体が俯瞰でき、かつ、側面の表面の微細な凹凸が目視できないスケール、解像度での断面写真において、測定点およびその近傍での傾斜の傾向をできるだけ反映するように測定点における接線を設定することが挙げられる。

[0019] (貫通孔の傾斜角度の測定方法)

まず、図1に本発明の第一実施形態で得られる貫通孔12の形状を説明している。図1は、円錐台形状の貫通孔12の断面および傾斜角度の測定方法を示す図である。図1に示される貫通孔12の断面は、貫通孔12を第一面101側より、ガラス基板の厚さ方向においてスクライブにて切断（裁断）して断面（裁断面）を出し、SEM（Scanning Electron Microscope：走査電子顕微鏡）によって観察されたSEM画像を画像解析ソフトを使用して解析したものである。図1において、パターン模様で示した箇所がガラス基板10を示している。図1に示す貫通孔12は、貫通孔12は第一面101と第二面102の間に貫通孔の径が極小となる極小値を持つ。極小値を持つ点を挟んで、第一面101側には円錐台形状が形成され、第二面102側にも円錐台形状が形成されている。なお、図1に示される目盛り5%、10%、・・・95%は、ガラス基板10の第一面101から第二面102までの長さを割合で示している。

ガラス基板10の第一面101側の貫通孔12の中心部に、第一面101と垂直になるように中心線TCを引く。次に、矢印に示されるように中心線TCを貫通孔12の両側のいずれか一方に向かって平行移動させ、平行移動させた中心線TCが貫通孔12の径が極小値を取る点と接触させ、接触させた点を基準点RPとする。そして、基準点RPから5%から100%のそれぞれの目盛り位置の高さの断面の位置に接線ssを引き、接線ssの傾斜角度を測定し、その傾斜角度を、5%から95%のそれぞれの断面の位置における傾斜角度であるとする。傾斜角度は、貫通孔12の径が上方に向けて広がる方向を正とする。

[0020] 上述のように、第一実施形態においては、傾斜角度の測定方法は、（１）貫通孔12の中心線を作成する、（２）中心線を開口部が極小値となる位置に水平移動し基準点を作成する、（３）基準点から貫通孔の特定の位置に接線を引き角度を測定する、という手順（１）から（３）を含む。特に（２）基準点を作成する手順を用いることにより、貫通孔全体を俯瞰するようなス

ケールでかつ側壁の微細な凹凸の影響を受けない信頼性の高い測定を行うことができる。

[0021] なお、具体的な傾斜角度測定では、貫通孔 1 2 を第一面 1 0 1 側より、スクライブおよび精密ブレイカーを使用し、貫通孔 1 2 を中央部で割断（裁断）して、貫通孔 1 2 の断面を表出させる。割断の方法としては、例えば 3 点曲げを適用することができる。その後、表出した断面について S E M 観察を実施し、断面の S E M 画像を画像解析することによって、貫通孔 1 2 の角度測定を実施している。

[0022] （側面粗さの計測方法）

続いて、貫通孔 1 2 の側面粗さの測定方法について説明する。貫通孔 1 2 の側面粗さに測定については、側面角度の測定と同様に貫通孔 1 2 の断面を S E M によって観察し、観察された S E M 画像を画像解析ソフトを使用して解析する。貫通孔の側面粗さを計測するためには、通常は、貫通孔の第一面 1 0 1 から第二面 1 0 2 に至る範囲を測定範囲とする。ただし、仮に、貫通孔に凹凸が存在している場合には、当該凹凸部を除いた範囲を 2 つ以上の測定範囲として設定し、それらの測定範囲の結果を平均して側面粗さとする。また、側面粗さの算出に当たっては、同じ条件で作成した貫通孔 5 つ（サンプル数 $n = 5$ ）について、同様の測定を行い、これらの平均値を当該条件で作成した貫通孔の側面粗さとして規定する。

図 2 は、貫通孔の側面粗さの測定方法を示す図である。図 2 に示す貫通孔 1 2 は、説明のため、一般的な形状のものを掲載している。図 2（a）は、貫通孔 1 2 の断面の S E M 画像を示す。図 2（b）は、貫通孔 1 2 の断面を観察した S E M 画像より、貫通孔 1 2 の側面の輪郭を抽出した図を示す。抽出された輪郭データより平均分散粗さおよび凹凸巾の測定を実施する。図 2（c）は、平均分散粗さの計算式および凹凸巾を模式的に示す図である。図 2（b）において抽出された輪郭データに関し、第一面 1 0 1 を基準として設定した設定領域 L において、輪郭の粗さを示す粗さ曲線 $f(x)$ を測定する。平均分散粗さ（以下、単に「分散粗さ」ともいう。） R_a は、式（1）

に示されるように、粗さ曲線 $f(x)$ の絶対値を 2 乗したものを、設定領域 L にわたって積分したうえで設定領域 L の長さで割ったものである。また、ラフネス幅（以下、「凹凸巾」ともいう。） a は、粗さ曲線 $f(x)$ のうち、粗さの最大値を示すピーク部と粗さの最小値を示すボトム部との差である。

なお、一つ貫通孔において、複数の粗さ曲線 $f(x)$ が設定された場合には、それらから算出された粗さの値の平均値によって当該貫通孔の平均粗さを算出することとなる。

[0023] （伝送特性の測定方法）

伝送特性の測定には、入力波に対する伝搬波の度合いの周波数依存性を示す S パラメータ (S_{21}) を用いる。 S_{21} は電力比（透過波電力／入力波電力）の対数で表され、絶対値が小さいほうが伝送損失が小さいことを示す。

S パラメータ (S_{21}) の測定にはネットワークアナライザを用いた。測定サンプルとしては、ガラス基板に形成した貫通電極 11 の周辺を導体で囲み、導体を接地した状態としたものを作製し、これによって、貫通電極 11 の第一面 101 側から第二面 102 側の間における S_{21} を測定した。

[0024] <第一実施形態に係る実施例および比較例>

第一実施形態における貫通孔 12 に実施形状について説明する。実施形態では、後述する図 25 に示されるように、レーザ改質部 65 が形成されたガラス基板 10 に対して、ガラス基板 10 の第二面 102 側からエッチングが行われる。このため、形成された貫通孔 12 は、第二面 102 から第一面 101 に向かって径が窄まる円錐台形状を有する。貫通孔 12 の側面の傾斜角度は、ガラス基板 10 に対するレーザ加工条件、エッチング条件によって変化する。

本発明の各実施例では、表 1 に示すパルス幅およびショット数の照射条件によってガラス基板にレーザ加工を行い、その後のエッチングにより貫通孔 12 を形成している。第一実施形態における実施例 1 においてはパルス幅が

5 p s かつショット数が 1、実施例 2 においてはパルス幅が 15 p s かつショット数が 1、実施例 3 においてはパルス幅が 25 p s かつショット数が 1 である。

また、比較例は、第一実施形態に示した製造方法とレーザ加工方法を変更して作成した貫通孔である。つまり、比較例 1 においてはパルス幅が 30 p s かつショット数が 1、比較例 2 においてはパルス幅が 30 n s かつショット数が 50、比較例 3 においてはパルス幅が 50 μ s かつショット数が 5 である。

なお、各実施例および各比較例のいずれについても、ガラス基板 10 の第二面 102 側の開口径は平均 80 μ m であり、この場合、計測値の平均値に標準偏差の 3 倍を加えた値である 3σ は 4.5 μ m 以下であった。また、形成されたレーザ改質部 65 の第二面 102 における開口径について、開口径の最大値 ϕ_{Max} と最小値 ϕ_{Min} の差は 10 μ m 以下であった。

[0025] [表1]

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2	比較例3
パルス幅	5ps	15ps	25ps	30ps	30ns	50us
ショット数	1	1	1	1	50	5

[0026] (貫通孔の傾斜角度)

以下、図 3 から図 23 を参照して、第一実施形態における各実施例、比較例の貫通孔の形状、特性形状を説明する。

図 3 は、第一実施形態における実施例 1 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

図 4 は、第一実施形態における実施例 2 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

図 5 は、第一実施形態における実施例 3 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

図 6 は、第一実施形態における比較例 1 の貫通孔の断面形状を示す図である。

図 7 は、第一実施形態における比較例 1 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示

す図である。

図 8 は、第一実施形態における比較例 2 の貫通孔の断面形状を示す図である。

図 9 は、第一実施形態における比較例 2 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

図 10 は、第一実施形態における比較例 3 の貫通孔の断面形状を示す図である。

図 11 は、第一実施形態における比較例 3 の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。

[0027] (傾斜角度)

表 2 は、実施形態の各実施例および各比較例における貫通孔 12 の側面の傾斜角度を測定した結果を表形式に取りまとめたものである。実施形態に係る各実施例では、貫通孔 12 に側面角度が第一面からの距離 0 % 以上 10 % 未満の範囲における値と、第一面からの距離 10 % 以上 95 % 以下の範囲における値との間に、差があることが確認されている。言い換えると、貫通孔 12 に側面角度が第一面からの距離 0 % 以上 10 % 未満の範囲においてほぼ一定であり（側面の角度は 4° 以上 7° 以下の範囲となり）、第一面からの距離 10 % 以上 95 % 以下の範囲においてほぼ一定となる側面の角度は -7° 以上 -15° 以下の範囲となる）ことが確認される。また、第一面からの距離 95 % 以上 100 % 以下の範囲における貫通孔 12 の側面の傾斜角度は、第一面からの距離 10 % 以上 95 % 以下の範囲における貫通孔 12 の側面の傾斜角度と同等の傾斜角度となり、2つの範囲における傾斜角度の差が 1.0° 以下となる。

各比較例では、距離 5 % 以上 95 % 以下の各位置で貫通孔 12 の側面の傾斜角度がばらつくことがわかる。本発明の各実施例と比較例では貫通孔の側面の傾斜角度の形状が大きく異なることがわかる。

[0028]

[表2]

	実施例1		実施例2		実施例3		比較例1		比較例2		比較例3	
	左側面	右側面	左側面	右側面	左側面	右側面	左側面	右側面	左側面	右側面	左側面	右側面
0%	6.9	6.6	5.5	5.4	4.1	4.4	-9.8	-10.5	-4.5	-6.1	-5.2	-7.1
5%	6.6	6.8	5.1	5.3	4.3	4.2	-8.3	-9.1	-3.1	-6.1	-9.2	-8.6
10%	-14.9	-14.3	-9.5	-9.1	-8.5	-8.1	-8.9	-9.1	-2.1	-4.5	-9.4	-3.6
20%	-13.8	-14.8	-9.1	-9.8	-8.3	-8.6	-7.1	-6.7	-3.5	-8.1	-8.7	-6.8
30%	-14.5	-13.4	-9.6	-9.7	-7.7	-8.9	-8.5	-5.9	-7.4	-3.5	-3.1	-1.1
40%	-14.3	-14.9	-8.9	-9.4	-8.6	-8.1	-8.3	-7.1	-9.5	-8.4	2.4	-2.3
50%	-14.1	-14.1	-10.1	-8.9	-8.1	-7.6	-6.5	-8.7	-9.3	-3.7	-3.7	-6.5
60%	-14.7	-13.9	-9.4	-9.3	-8.1	-8.2	-5.7	-4.5	-9.5	-8.4	2.4	-2.3
70%	-14.3	-14.5	-9.2	-9.6	-8.9	-8.1	-8.6	-3.9	-7.4	-3.5	-3.1	-1.1
80%	-14.6	-14.2	-9.7	-9.5	-8.5	-7.8	-3.4	-8.1	-8.5	-6.8	3.4	-5.6
90%	-14.2	-14.8	-9.5	-9.7	-8.4	-8.6	-4.5	-5.5	-9.4	3.2	-5.1	-2.1
95%	-14.4	-14.5	-9.6	-9.8	-8.4	-8.5	-6.3	-4.3	-10.4	-11.6	-19.6	-20.1
100%	-14.2	-14.2	-9.4	-9.2	-8.1	-7.8	-7.8	-8.4	-12.5	-13.4	-21.5	-22.1

[0029] (平均分散粗さおよび凹凸巾)

次に、表3を用いて第一実施形態における各実施例および各比較例に関し貫通孔12の側面の平均分散粗さおよび凹凸巾について説明する。表3に示されるように、第一各実施例では、ガラス基板の厚さ方向における貫通孔12の裁断面における側面形状の分散粗さが1,000nm以下かつ凹凸巾が1,500nm以下となる。各比較例では、分散粗さが1,500nm以上かつ凹凸巾が1,500nm以上となり、貫通孔側面の粗さに差があることが確認されている。

[0030] [表3]

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2	比較例3
分散粗さ	30.5nm	501.3nm	985.1nm	1623.5nm	1829.4nm	1789.5nm
凹凸巾	316.2nm	982.1nm	1323.5nm	1756.4nm	199.61nm	1985.4nm

[0031] (応用例の傾斜角度) 続いて、図12から図14に本発明に係る第一実施形態の応用例として、貫通孔12の側面傾斜角度の変曲点を第一面からの距離1%以上5%以下の範囲に形成した結果を示す。図12は、応用例1の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。図13は、応用例2の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。図14は、応用例3の貫通孔の傾斜角度の測定結果を示す図である。表4に各応用例での貫通孔12の側面の傾斜角度を測定した結果を示す。なお、後述するように、エッチング加工については噴流を使用した浸漬処理が行われるところ、各応用例は、各比較例に比べて噴流の方向の切り替えを緩くして形成されている。パルス数およびショット数については、各応用例の条件は、各実施例の条件と同様とした。

各応用例では、貫通孔12に側面角度が第一面からの距離0%から5%の

範囲においてほぼ一定であり、第一面からの距離５％から９５％の範囲においてほぼ一定となることが確認された。また、第一面からの距離９５％から１００％の範囲における貫通孔１２の側面の傾斜角度は、第一面からの距離１０％から９５％までの範囲における貫通孔１２の側面の傾斜角度と同等の傾斜角度となり、２つの範囲における傾斜角度の差が１．０°以下となる。なお、貫通孔側面の粗さについては、実施例１から３と同様のレーザ加工条件およびエッチング液の組成を使用していることから、表３と同様の値、すなわち分散粗さが１０００ｎｍ以下かつ凹凸巾が１５００ｎｍ以下となる。

[0032] [表4]

	応用例1		応用例2		応用例3	
	左側面	右側面	左側面	右側面	左側面	右側面
0%	6.7	6.3	5.2	5.1	4.0	4.3
5%	-14.1	-14.2	-9.5	-10.1	-8.6	-8.5
10%	-14.2	-14.3	-9.9	-9.6	-8.8	-8.1
20%	-14.6	-14.3	-9.3	-9.4	-8.2	-8.7
30%	-13.9	-13.9	-9	-9.8	-8.3	-8.9
40%	-14.3	-14.1	-9.4	-9.8	-8.1	-8.5
50%	-14.7	-14.1	-9.7	-9.3	-8.3	-7.9
60%	-14.1	-13.7	-9.9	-9.9	-8.1	-8.2
70%	-13.8	-14.4	-9.6	-9.4	-8.9	-8.1
80%	-14.3	-14.6	-9.4	-9.6	-8.5	-8.3
90%	-14.0	-14.4	-9.8	-9.2	-8.4	-8.6
95%	-13.9	-14.1	-9.3	-9.5	-7.9	-8.5

[0033] (開口径)

表５および図１５Ａを用いて、本発明の実施形態に係る貫通孔の第一面と第二面の開口径の関係性を説明する。表５は、実施例１の条件下でガラス基板１０の厚さを１００μｍから２００μｍに変更した場合の貫通孔１２の第一面１０１における開口部の径および第二面１０２における開口部の径を示す。図１５Ａは、表５をグラフにして示す図である。第一実施形態によれば、第二面１０２の開口径に関わらず、第二面１０２の開口径と第一面１０１の開口径の関係性は、第一面側開口径Φ１／第二面側開口径Φ２≧０．４以上となる。

[0034]

[表5]

第二面開口径: $\Phi 2$	第一面開口径: $\Phi 1$	$\Phi 1 / \Phi 2$
100.3	58.3	0.58
95.5	53.9	0.56
91.1	49.8	0.55
85.8	47.4	0.55
80.4	44.2	0.55
75.4	39.8	0.53
70.5	33.5	0.48
65.7	26.3	0.40

単位: μm

[0035] 次に表 6 に、第一実施形態における各実施例および各比較例の第一面開口径と第二面開口径を示す。表 6 には、第一実施形態における各実施例および各比較例において計測された、貫通孔 1 2 の第一面 1 0 1 側の開口径 $\Phi 1$ と第二面 1 0 2 側の開口径 $\Phi 2$ の典型的な値が示される。

[0036] [表6]

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例 1	比較例 2	比較例 3
第二面開口径 $\Phi 2$	71.6	80.5	72.6	75.3	78.5	69.8
第一面開口径 $\Phi 1$	33.2	60.7	46.1	54.6	45.6	57.1

単位「 μm 」

[0037] ここで、図 1 5 B を参照して、開口径と伝送特性の関係を説明する。図 1 5 B は、貫通電極 1 2 を形成した場合を示す模式的に示す図である。貫通孔 1 2 の開口径は、 $\Phi 1 / \Phi 2 \geq 0.4$ という関係に示されるように、 $\Phi 2$ にくらべて $\Phi 1$ を小さくすることができる。例えば、後述する通信用デバイスとして用いられる場合には貫通電極 1 1 を利用してコイルが形成されるところ、 $\Phi 1$ と $\Phi 2$ の関係からコイルの設計自由度を確保することが可能となる。また、パッド間の距離 D_p を確保できるため、コイルを含む回路を形成した場合に Q 値を小さくすることができ、伝送損失を抑制することが可能である。上記内容より、貫通電極の信号を安定化（信号損失の低減）が可能となる。

[0038] （本開示の貫通孔および貫通電極の特徴）

また、図 1 5 C は、本開示において形成される貫通孔および貫通電極の特徴を説明する図である。図 1 5 C は、例えば、図 2 9 の領域 R_a を拡大して示す図である。図 1 5 C に示されるように、貫通孔 1 2 （または貫通電極 1

1) の直上に、導通電極 31 を形成することができる。これは、貫通孔 12 が所謂、有底形状であるためである。有底形状にすることで、貫通孔 12 上に直接に導通電極 31 を形成することが可能となる。このため、電極全体としての伝送距離が短縮され、伝送特性の向上および貫通孔 12 の微細化が可能となる。

また、実施形態において説明したように、本開示における貫通孔 12 の側面には側面形状が変化する変曲点がなく、表面が滑らかである。したがって、貫通孔 12 にめっき処理を行う場合、均一な金属膜等を形成することができるため、貫通孔 12 側面において寄生容量の発生を抑制することができる。貫通孔 12 の形状は、変曲点を有する形状や、ガラス基板の第一面から第二面まで径がほとんど変化しない所謂ストレート形状とすることも可能であるが、伝送特性の観点からは、寄生容量の発生を抑制することができる本開示に示す形状が望ましい。

[0039] (断面形状)

次に、貫通孔 12 の側面形状について説明する。図 16A から図 16D は、各実施例および比較例に関し貫通孔の側面を説明する図である。図 16A は、第一実施形態における各実施例および各比較例の貫通孔の典型的な断面形状の SEM 画像を示す図である。

[0040] SEM 画像は、ガラス基板の厚さ方向における貫通孔の裁断面を撮影したものである。図 16A から図 16D に示される SEM 画像は、倍率は 1000 倍である（スケールの 1 目盛りは 5 μm である）。

図 16A においては、第一実施形態にかかるガラス基板の断面形状を観察しやすくするため、貫通孔 12 を樹脂材料を充填させている。第一面 101 から第二面 102 に向かうにつれて、側面の傾斜角度が変化する様子が分かる。

[0041] 図 16B は、第一実施形態における各実施例および各比較例の貫通孔の断面形状の SEM 画像を示す図である。図 16B において、傾斜角度および断面形状は上述のものとは異なるが、パルス幅およびショット数の条件は各実

施例および各比較例において説明したとおりである。SEM画像の見え方および貫通孔の断面の平滑さに関しては、共通の性質を有している。

SEM画像において、コントラストが高く白色に見える箇所は、試料表面の傾斜面の角度が切り替わり、傾斜面の稜線となっている領域である。このため、白線で見える箇所は、試料表面の粗さのピークまたはボトムを示す箇所であり、これらの貫通孔の側面に形成されている稜線の存在状況や配置の程度によって、貫通電極の伝送特性に影響を与える貫通孔の側面の粗さを把握することができる。

[0042] 図16Bに示す第一実施形態の各実施例では、ガラス基板10の第一面101と平行な方向や略平行な方向に延びる白線の稜線が現れて複数視認でき、帯状の縞模様が形成されている。

ここで、図16Cを参照して、貫通孔の断面の稜線について説明する。図16Cは、第一実施形態における各実施例の貫通孔の稜線を説明する図である。図16C(a)は図16Bの実施例3を拡大して示す図である。また、図16C(b)は、SEM画像において観察される貫通孔について、側面および断面の稜線を実線で示す図である。

図16C(b)に示される例では、略平行な稜線のうち、稜線の間隔がもっとも広くなる場合は、稜線R11と稜線R12の間である。図16C(b)に示される例では、第一面101と垂直な方向の側面上の稜線の間隔はRs以下である。図16C(a)に示されるように、実施例3においては、稜線の間隔は、15.5 μm 以下である。

同様の手法で、稜線の状況を確認すると、実施例1においては、第一面101と垂直な方向における稜線と稜線の間隔は、2 μm 以上3 μm 以下の範囲である。また、実施例2においては、ガラス基板10の第一面101と垂直な方向における稜線と稜線の間隔は、5 μm 以上6 μm 以下の範囲である。

[0043] また、図16Bから明らかなように、第一実施形態における実施例3から1に変化するにつれて、つまり、貫通孔の側面の平滑度である分散粗さが小

さくなるにつれて、貫通孔12の側面において、ガラス基板10の第一面101に平行な方向に延びる稜線として認識できる白線が緻密になり、稜線と稜線の間隔が狭くなる。これとは反対に、分散粗さが大きくなるほど（すなわち、実施例1から実施例3に変化し、さらに、比較例1から比較例3に変化するにつれて、稜線と稜線との間隔が大きくなるとともに、第一面101と平行ではない方向に延びる稜線も増えてくる。そして、更には、第一面101と垂直な方向に延びる稜線や第一面101と平行な方向と垂直な方向との間の方向（以下、「斜方向」ともいう。）に延びる白線の発生頻度が多くなることが分かる。これらは、分散粗さが小さくなるほど、垂直方向に延びる稜線および斜方向に延びる稜線の割合が少なくなること示している。例えば、実施例2においては、平均分散粗さが500nmであって、凹凸巾が980nmの場合、第一面101に平行な方向と第一面101と垂直な方向の間の方向（つまり斜方向）に延びる白線が視認可能になる。

[0044] 一方、実施形態における比較例1から3のように貫通孔の側面が粗くなる（分散平均粗さ1,000nmより大きくかつ凹凸巾1,500nmより大きい）場合、ガラス基板10の第一面101に垂直な方向に、または第一面101に垂直な方向と第一面101に平行な方向の間の斜方向に、延びる白線の割合が増えてくる。すなわち、斜方向において、稜線が複数視認可能になる。このような貫通孔12側面の平滑性（粗さ）がSEM画像に表れ、また、貫通電極の伝送特性に影響することがわかる。

[0045] なお、図16Dは、第一実施形態における貫通孔に貫通電極を形成した場合の断面のSEM画像を示す図である。図16Dにおいて、傾斜角度および断面形状は上述のものとは異なるが、パルス幅およびショット数の条件は各実施例および各比較例において説明したとおりである。SEM画像の見え方および貫通孔の断面の平滑さに関しては、共通の性質を有している。

ここに示されるように、矢印で差し示されて破線で囲まれた箇所は、端部が立つ形状を有している。言い換えると、貫通孔12の側面とガラス基板10の第二面102との間には、ゆるやかに変化する箇所がなく、断面視にお

いて角度が一変している。つまり、貫通孔 12 の側面とガラス基板 10 の第二面 102 とは、端部が立つ形状を有しており、1000 倍の SEM 画像において、側面と第二面の領域とが明確に識別できる形状となっている。

[0046] (伝送特性)

続いて、図 17 を用いて、本発明の第一実施形態での各実施例、各比較例の貫通電極の伝送特性について説明する。図 17 は、第一実施形態における実施例 1 の貫通電極の伝送特性と、比較例 1 の貫通電極の伝送特性を示す図である。図 17 では貫通電極における伝送特性として伝送損失 S_{21} を測定した結果を示す。なお、実施例 1 から 3 は伝送特性が同じ傾向を示したため、代表して実施例 1 を示している。また、比較例 1 から 3 についても伝送特性がほとんど同じ傾向を示したので、代表して比較例 1 を示している。電極を形成するためのシード層の形成およびめっき処理等の形成条件は、実施例および比較例のいずれも共通とした。図 17 に示されるように、いずれの周波数領域においても、実施例の伝送損失のほうが比較例の伝送損失よりも小さいことが示される。したがって、貫通孔の側面については、分散粗さ、凹凸巾の値が小さいほど、貫通孔に形成される貫通電極における損失が小さくなり、伝送特性が良いことが分かる。

[0047] (ガラス基板の厚みを変更した場合の伝送特性)

また、各実施例および各比較例について、ガラス基板 10 の厚みを変更させた場合の伝送特性 S_{21} についても測定した。この結果を表 6 に示す。表 7 に示されるように、ガラス基板 10 の厚みを $100\ \mu\text{m}$ 、 $150\ \mu\text{m}$ 、 $200\ \mu\text{m}$ に設定したうえで、各実施例および各比較例に基づく条件で貫通孔及び貫通電極を作成し、の伝送特性を計測した。表 7 に示されるように、第一実施形態における各実施例では、各比較例に比べ伝送特性 S_{21} が良好な値を示していることが確認される。

[0048] 表 7 に示す伝送特性は、単一の貫通電極の伝送特性となっており、複数個の貫通電極を必要とする多層配線基板では、単一貫通電極の伝送特性の向上が大きな性能向上につながる。第一実施形態に係る各実施例を使用すること

で、既存技術と比較し、高周波数帯での貫通電極の良好な伝送特性を実現した多層配線基板を得ることが可能となる。

なお、伝送特性の観点から、実施例 1 から 3 に示される貫通電極が比較例 1 から 3 に示される貫通電極よりも良好な結果が得られている。実施例の中で比較すると、実施例 1 が最も好ましく、実施例 2、実施例 3 の順に良好であるということが出来る。

[0049] [表7]

周波数	ガラス厚	実施例1		実施例2		実施例3		比較例1		比較例2		比較例3	
		測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定
5GHz	100um	-0.0079	良好	-0.0082	良好	-0.0087	良好	-0.0090	-	-0.0090	-	-0.0090	-
	150um	0.0083	良好	0.0087	良好	0.0094	良好	0.0098	-	0.0099	-	0.0099	-
	200um	-0.0091	良好	-0.0101	良好	-0.0106	良好	-0.0111	-	-0.0112	-	-0.0112	-
10GHz	100um	-0.0140	良好	-0.0148	良好	-0.0154	良好	-0.0157	-	-0.0157	-	-0.0157	-
	150um	-0.0145	良好	-0.0156	良好	-0.0165	良好	-0.0169	-	-0.0170	-	-0.0170	-
	200um	0.0161	良好	0.0189	良好	0.0189	良好	0.0193	-	0.0194	-	0.0194	-
20GHz	100um	-0.0293	良好	-0.0302	良好	-0.0309	良好	-0.0314	-	-0.0314	-	-0.0314	-
	150um	0.0288	良好	0.0298	良好	0.0315	良好	0.0321	-	0.0321	-	0.0321	-
	200um	-0.0312	良好	-0.0379	良好	-0.0352	良好	-0.0357	-	-0.0358	-	-0.0358	-
28GHz	100um	-0.0442	良好	-0.0456	良好	-0.0463	良好	-0.0469	-	-0.0469	-	-0.0469	-
	150um	-0.0441	良好	-0.0450	良好	-0.0468	良好	-0.0471	-	-0.0471	-	-0.0471	-
	200um	0.0486	良好	0.0595	良好	0.0537	良好	0.0542	-	0.0544	-	0.0544	-
56GHz	100um	-0.0851	良好	-0.0914	良好	-0.1040	良好	-0.1337	-	-0.1457	-	-0.1517	-
	150um	-0.0976	良好	-0.1013	良好	-0.1160	良好	-0.1537	-	-0.1875	-	-0.1915	-
	200um	-0.1094	良好	-0.1213	良好	-0.1340	良好	-0.1854	-	-0.1984	-	-0.2184	-
84GHz	100um	-0.1891	良好	-0.2014	良好	-0.2114	良好	-0.2527	-	-0.2727	-	-0.2827	-
	150um	-0.2004	良好	-0.2212	良好	-0.2114	良好	-0.2827	-	-0.3127	-	-0.3193	-
	200um	0.2114	良好	0.2421	良好	0.2114	良好	0.3027	-	0.3374	-	0.3474	-

[0050] 表 8 および表 9 に T C T 試験（温度サイクル試験：Temperature Cycling Test）による信頼性評価結果を示す。信頼性試験条件は次の通りとなる。

- ・ 設定条件：下限温度 -40°C / 30 分、上限温度 150°C / 30 分とした。
- ・ 試験装置 T S A - 4 3 E L（エスペック製）
- ・ 各サイクル数で貫通電極を含む配線経路を抵抗の上昇を測定。
- ・ N G 基準：サイクル後の抵抗値が初期状態の抵抗値の 10 倍を超える場合に N G と判定

[0051] 表 8 および表 9 に示すように、本発明の実施形態に係る各実施例では、各比較例と比べ高い信頼性が高くなることが示されている。

[0052]

[表8]

	実施例1		実施例2		実施例3		比較例1		比較例2		比較例3	
	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定
50cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
100cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
200cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
300cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
400cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
500cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Passed	NG
600cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Passed	NG
700cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Passed	NG
800cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Passed	NG
900cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Failed	NG
1000cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Failed	NG
1500cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好	Failed	NG	Failed	NG	Failed	NG

[0053] [表9]

	応用例1		応用例2		応用例3	
	測定値	判定	測定値	判定	測定値	判定
50cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
100cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
200cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
300cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
400cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
500cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
600cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
700cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
800cyc:e	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
900cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
1000cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
1500cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好
2000cycle	Passed	良好	Passed	良好	Passed	良好

[0054] <第一実施形態における多層配線基板の構成>

図18は、第一実施形態における多層配線基板1の構成の一例を示す図である。また、図19は、第一実施形態における多層配線基板1の構成の他の例を示す図である。多層配線基板1は、ガラス基板10、第一配線層21、および第二配線層22を含む。ガラス基板10の第一面101側には第一配線層21、ガラス基板10の第二面102側には第二配線層22が配置されている。ガラス基板10は、第一面101側から第二面102側まで貫通する貫通孔12を備える。貫通電極11は、貫通孔12の側面に沿って形成された導電体によって構成される。貫通電極11は第一配線層21の一部と第二配線層22の一部とを電氣的に接続する。第一配線層21および第二配線層22は絶縁樹脂層25を含む。第一配線層21および第二配線層22は複数の層が積層された構成でもよく、その層数は必要に応じて設定してよい。貫通電極11は、第一配線層21と第二配線層22の間に電氣的な接続を確立するための電極である。導通電極31は、多層配線基板1において基板の厚さ方向に導通を確保するための電極である。また、半導体素子用接合パッ

ド50は、多層配線基板1に搭載する半導体回路を接続するための部材である。基板用接合パッド54は、多層配線基板1と他の基板とを接合するための部材である。

なお、貫通電極は、ガラス基板10の第一面101側から第二面102側を電氣的に接続が可能であれば、図18に示すように貫通孔12の側面のみで導電体を配置してもよいし、図19に示すように貫通孔12に導電体を埋め込んでも構わない。

第一実施形態では、第一配線層21の貫通電極11のZ軸方向上に導通電極31を配置することが可能となる。

[0055] なお、図18および図19において、貫通孔12の形状は詳細を省略して示している。図20から図29においても同様に省略してある。

[0056] また、多層配線基板1の厚みは、例えば、100 μ m以上400 μ m以下の範囲である。

[0057] <第一実施形態における多層配線基板の製造方法>

多層配線基板1の製造方法について、図3から図12を用いて説明する。
まず、ガラス基板10に貫通孔12を形成する工程について説明する。

[0058] [第一支持体の接着工程]

図20は、ガラス基板10を第一支持体62に張り合わせる工程を示す図である。

ガラス基板10の厚みは、エッチング後の厚みを考慮したうえで、用途に応じて適宜設定することができる。

[0059] 図20に示されるように、第一接着層61において、ガラス基板10に第一支持体62が貼り合わされており、ガラス基板10、第一接着層61、第一支持体62を含む積層構造体63が形成される。

[0060] なお、ガラス基板10と第一支持体62は、第一接着層61によって仮固定されている。

ガラス基板10に第一支持体を貼り合わせるためには、例えば、ラミネーター、真空加圧プレス、減圧貼り合わせ機等を使用することができる。

[0061] 前記第一支持体62は、例えば、ガラス基板10と同一の材料であることが望ましい。ガラス基板10の SiO_2 比率が55質量%以上81質量%以下の範囲である無アルカリガラスである場合、第一支持体62も無アルカリガラスであることが望ましい。また第一支持体62の厚みについては、ガラス基板10の厚みに応じて、適宜設定することができる。ただし、製造工程中に搬送可能な厚みであることが望ましく、支持体の厚みは、例えば $300\mu\text{m}$ 以上 $1,500\mu\text{m}$ 以下の範囲とする。

[0062] ガラス基板10については、例えば SiO_2 比率が55質量%以上81質量%以下の範囲である無アルカリガラスを用いることができる。ガラス基板10の SiO_2 比率が81質量%より大きい場合、エッチングの加工速度が低下し、貫通孔12の側面角度が低下し、後述する貫通電極11の形成時に付き回り不良が発生してしまう。また、 SiO_2 比率が55質量%より小さい場合、ガラス中にアルカリ金属が含まれる可能性が高くなり、電子デバイス搭載後の多層配線基板の信頼性に影響する。 SiO_2 比率55質量%以上81質量%以下の範囲である無アルカリガラスであれば、適宜設定比率を設定して構わない。

[0063] [レーザ改質工程]

続いて、図21は、レーザ改質部を形成する工程を示す図である。ガラス基板10にレーザ加工を実施することによって、ガラス基板10にレーザ改質部65が形成される。レーザ改質部65は、ガラス基板10に対し $\Phi 3\mu\text{m}$ 以下の形状で加工されており、ガラス基板10の厚み方向に連続的に形成される。この時、レーザ改質部65の周辺には、 $5\mu\text{m}$ 以上の微小なクラック（以下、「マイクロクラック」ともいう。）が発生していないことが望ましい。レーザ改質部65の周辺に $5\mu\text{m}$ 以上のマイクロクラックが発生すると、エッチング加工後の貫通孔12に側面で分散粗さが 1000nm 以上かつ凹凸巾が 1500nm 以上となり、平滑な側面の貫通孔12を得ることが困難となる。また、 $5\mu\text{m}$ 以上のマイクロクラックが発生した場合、後述するように、エッチング後の貫通孔12の側面ではガラス基板10の第一面1

01にと垂直な方向において、間隔をおいて変化する粗さが発生する。

[0064] レーザ改質部65の加工については、例えば、フェムト秒レーザまたはピコ秒レーザを用い、且つレーザ発振波長は1064nm、532nm、または355nmのうちのいずれかの波長を使用することが好ましい。レーザのパルス幅が25ピコ秒以上ではレーザ改質部65の周辺に5 μ m以上のマイクロクラックが発生し易くなることから、レーザパルス幅は25ピコ秒以下であることが望ましい。また、複数回のパルス照射による加工を行うとマイクロクラックが発生し易くなることから、1パルスでレーザ改質部65を形成することが望ましい。レーザ改質部65の周辺に5 μ m以上のマイクロクラックが発生しない条件であれば、レーザ発振波長およびレーザ出力は、ガラス基板10の厚みに応じて、適宜設定して構わない。すなわち、レーザ改質工程（第1の工程）において、ガラス基板に対して、貫通孔形成予定部にレーザを照射し、レーザ照射周辺部に発生するマイクロクラックの最大長さが5 μ mである、ということもできる。

[0065] [第一配線層の形成]

続いて、図22は、第一配線層21を形成する工程を示す図である。図22に示されるように、積層構造体63のガラス基板10上の第一面101に導電層と絶縁樹脂層からなる第一配線層21の形成を行う。ここでは、ガラス基板10上には耐フッ酸金属層を含むシード層を形成した後に、セミアディティブ（SAP）工法で第一面101に貫通電極接続部41（または貫通電極間の配線）を形成する。不要となったシード層を除去した後に、絶縁樹脂層25を形成する。

[0066] なお、シード層の形成について、ガラス基板10上の耐フッ酸金属層は、クロム、ニッケル、または双方を含む合金層であり、スパッタ処理にて10nm以上1,000nmの範囲で形成することができる。その後、耐フッ酸金属上に導電金属皮膜を所望の厚みで形成する。導電金属皮膜は、例えば、Cu、Ni、Al、Ti、Cr、Mo、W、Ta、Au、Ir、Ru、Pd、Pt、AlSi、AlSiCu、AlCu、NiFe、ITO、IZO、

A Z O、Z n O、P Z T、T i N、C u₃N₄から適宜設定することができる。

[0067] セミアディティブ工法においては、めっきによる配線パターンを形成するために、フォトレジストを使用して所望のパターンを形成する。一般的には、ドライフィルムレジストを用いるが、液体のレジストを使用しても構わない。所望のパターンを露光、現像しパターン形成した後に、電解めっきにてめっき被膜を形成し、不要となったレジストを剥離し、シード層をエッチングすることで配線形成を行うことができる。

[0068] [絶縁樹脂層]

次に絶縁樹脂層 2 5 の形成について、絶縁樹脂層 2 5 は熱硬化性樹脂であり、その材料は、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミド系樹脂の少なくとも一つを含み、かつシリカ S i O₂ フィラーを含む材料である。絶縁樹脂層 2 5 の材料は、必要に応じて適宜選択することができる。但し、感光性絶縁樹脂材料を用いる場合は、フォトリソグラフィ性を確保するためにシリカ S i O₂ フィラーの充填が困難となるため、感光性絶縁樹脂材料も使用可能であるが、熱硬化性樹脂を用いる方がより好ましい。

[0069] [第二支持体の接着工程]

次に図 2 3 は、第二支持体を接着する工程を示す図である。図 2 3 に示されるように、積層構造体 6 3 の第一配線層 2 1 上に第二接着層 7 1 を形成し、第二接着層 7 1 上に第二支持体 7 0 を配置し接着する。

第二支持体 7 0 については、例えばガラスを用いることができ、ガラス基板 1 0 と同一の材料であることが望ましい。ガラス基板 1 0 が無アルカリガラスである場合、第二支持体 7 0 も無アルカリガラスであることが望ましい。また第二支持体 7 0 の厚みについては、ガラス基板 1 0 の厚みに応じて、適宜設定することができる。ただし、搬送可能な厚みであることが望ましく、その範囲は、3 0 0 μ m 以上 1 , 5 0 0 μ m 以下の範囲である。

[0070] [剥離工程]

次に、図 2 4 は、第一支持体を剥離する工程を示す図である。図 2 4 に示

されるように、ガラス基板 10 と第一支持体 62 を第一接着層 61 において剥離する。

[0071] [貫通孔の形成]

続いて、図 25 は、貫通孔 12 を形成する工程を示す図である。

[0072] [エッチング工程]

レーザ改質部 65 が形成されたガラス基板 10 に対し、所定のエッチング液でエッチング処理を施すことで貫通孔 12 が形成される。また、同時に、ガラス基板 10 の第二面もエッチングされ、ガラス基板 10 の厚さが減少することとなる。エッチングはガラス基板 10 の第二面 102 側から行われる。

[0073] [エッチング液]

エッチング液は、フッ酸を 0.2 質量%以上 20.0 質量%以下の範囲とし、硝酸を 4.0 質量%以上 25.0 質量%以下の範囲とし、フッ酸および硝酸以外の無機酸を 0.5 質量%以上 11.0 質量%以下の範囲として含有するものが用いられる。フッ酸および硝酸以外の無機酸としては、例えば、塩酸、硫酸、リン酸、スルファミン酸等が挙げられ、ガラス基板 10 中に含まれるケイ素以外の成分の種類に応じて、少なくとも 1 つの無機酸を含有させる。望ましくは、塩酸および硫酸を含有させたエッチング液であり、ガラス基板 10 に対するエッチングレートとしては、 $0.1\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以上 $10\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以下の範囲になるように適宜調整される。ガラス基板 10 に対するエッチングレートは、望ましくは $0.25\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以上 $4\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以下の範囲であり、より望ましくは $0.25\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以上 $0.5\ \mu\text{m}/\text{分}$ 以下の範囲である。エッチング温度としては、特に限定されず、適宜調整することができるが、例えば 10°C 以上 30°C 以下の範囲となる。

[0074] エッチング加工については、噴流を使用した浸漬処理、スプレー処理によってエッチング加工を行い、貫通孔 12 に形成を行う。噴流を使用した浸漬処理の場合、例えば、貫通孔 12 の底部を効率的にエッチング行うために、エッチング液中で噴流の方向を切り替えて加工することが挙げられる。噴流

の方向を切り替えるタイミングを早く設定することで、貫通孔 1 2 の底部に圧力を加えることで、第一面からの距離 1 ～ 1 0 % の位置で、T G V 側面の傾斜角度を変化させる事が可能となる。スプレー処理によるエッチング加工も同様に、エッチング液を噴射する噴射口を有するスプレーの揺動速度、もしくは基板の揺動速度を速く設定することで、貫通孔 1 2 の底部の圧力を加えることで、第一面からの距離 1 % 以上 1 0 % 以下の位置で、T G V 側面の傾斜角度を変化させる事が可能となる。

なお、噴流を使用した浸漬処理、スプレー処理によるエッチング加工では、使用する装置のサイズによって、加工条件が異なることから、貫通孔 1 2 の形状を確認し、加工条件を設定することが望ましい。また、噴流を使用した浸漬処理では、他の機構として、超音波等を合わせて使用しても構わない。

[0075] [貫通電極の形成]

次に、図 2 6 を参照して、貫通電極 1 1 の形成工程について説明する。図 2 6 は、貫通電極 1 1 を形成する工程を示す図である。

[0076] 貫通孔 1 2 が形成されたガラス基板 1 0 に対し、第二面 1 0 2 から、電解メッキ処理のための金属層を形成する。金属層については、電解めっき処理のシード層として機能する金属であればよく、例えば、C u、T i、C r、W、N i 等を含む金属である。金属層には上記金属のうち少なくとも 1 つが用いられ、また金属層の最表面に C u 層が形成されていることが望ましい。T i、C r、W、N i については、C u 層の下部のガラス基板 1 0 との密着層として使用されることが望ましい。金属層の厚みは、貫通孔 1 2 の側面を覆うことができる範囲に適宜設定される。形成方法としては、例えばスパッタリングを用いた蒸着による形成方法を採用することが可能である。

[0077] 続いて、上記金属層をシード層として用いる電解めっき処理によって、貫通電極 1 1 を形成する。貫通孔 1 2 内を選択的に成長させるために、ガラス基板 1 0 の第二面 1 0 2 において貫通孔 1 2 および貫通孔 1 2 の周りの所定の範囲にレジスト等の絶縁体でマスクを形成しておき、電解めっき処理を行

う。電解めっき処理に用いる材料については、例えばCuを用いることが可能であり、他の金属としては、Au、Ag、Pt、Ni、Sn等を含む金属を用いることも可能である。多層配線基板の用途に応じて、上記金属等の導電体で貫通孔12内が充填されるように電解めっき処理を行っても構わない。

[0078] また、図27を参照して、絶縁樹脂層25の形成工程について説明する。図27は、絶縁樹脂層を形成する工程を示す図である。貫通電極を形成するための電解めっき処理をした後は、レジスト等の絶縁体を除去し、ガラス基板10の第二面102に形成されたシード層とした金属膜を除去する。ガラス基板10に形成された複数の貫通電極11それぞれを電氣的に独立させた後に、図27に示すように第二面側に絶縁樹脂層25の形成を行う。

[0079] [第二支持体の剥離]

続いて、図28を参照して、第二支持体70および第二接着層71の剥離工程について説明する。図28は、第二支持体70および第二接着層71を剥離する工程を示す図である。図28に示されるように、第一配線層21の上方に形成された第二接着層71および第二支持体70を、第一面101側の第一配線層21と第二接着層71の界面より剥離する。これによって、図28に示されるように、第一面101側に第一配線層21、第二面102側に第二配線層22が形成された状態のガラス基板10が得られる。

第二支持体70を第二配線層22から剥離するにあたっては、第二接着層71に使用した材料に応じて、UV光の照射、加熱処理、物理剥離等から使用材料に応じた剥離方式を適宜選択することができる。また、第一配線層21と第二接着層71との接合面に、第二接着層71の残差が生じる場合、プラズマ洗浄、超音波洗浄、水洗、アルコールを使用した溶剤洗浄などを行ってもよい。

[0080] [第一配線層および第二配線層の形成]

続いて、図29を参照して、ガラス基板10に形成される第一配線層21および第二配線層22の形成について説明する。図29は、第一配線層21および第二配線層22を形成する工程を示す図である。貫通電極11が形成

されたガラス基板 10 に対し、第一面 101 に第一配線層 21 を形成し、第二面 102 に第二配線層 22 を形成する。第一配線層 21 および第二配線層 22 の形成工程において、最初に、感光性のレジストまたはドライフィルムレジストによってパターンを有するマスクを形成した後に、電解めっき処理によって配線を形成する。その後、物理密着処理、もしくは、化学的な密着処理を施した後に、絶縁樹脂層 25 を積層する。導通電極 31 については、レーザ加工等によって絶縁樹脂層 25 に孔を形成した後に、無電解めっき、もしくは、スパッタリングによる蒸着処理によって金属皮膜を形成する。上記金属皮膜にレジストを用いてパターンを有するマスクを形成し、電解めっきによって形成した孔に導電体を充填する。その後、マスクおよび余分の金属皮膜を除去する。上記工程は必要な層数に応じて複数回繰り返すことで、第一配線層 21 および第二配線層 22 が形成される。なお、第一配線層 21 および第二配線層 22 は多層配線基板 1 の反りを抑制するために、同じ層数であることが望ましい。第一配線層 21 および第二配線層 22 の層厚が異なる場合は、第一配線層 21 と第二配線層 22 に層数を変えても構わない。多層配線基板の用途に応じて、第一配線層 21 の層数および第二配線層 22 の層数は適宜設定してよい。

[0081] <第二実施形態>

図 30 は、半導体素子 100 と BGA (Ball Grid Array : ボールグリッドアレイ) 基板 90 のインターポーザ基板として、多層配線基板 1 を用いる場合を示す図である。図 31 は、図 30 の場合の断面を示す図である。また、図 32 は、通信用の電子デバイスに多層配線基板 1 および半導体素子 100 が用いられる場合を示す図である。図 33 は、図 32 の場合の断面を示す図である。電子デバイスとしては、層厚が 800 μm 以下のものが用いられる。

上記電子デバイスは、貫通電極の伝送特性の影響によって、適応用途が限られており、本発明のガラス基板を用いた多層配線基板を使用することで電子デバイスの高周波数帯領域での適応が可能となる。

[0082] ＜作用・効果＞

以上、本発明によれば、良好な伝送特性および高い信頼性を備えた貫通電極を形成することが可能なガラス基板およびそのようなガラス基板を備えた多層配線基板を得るが可能となる。

[0083] （他の実施態様）

本開示は、次の態様も含む。

（態様１）

第一面と第二面を有し、前記第一面から前記第二面まで貫通する少なくとも１つの貫通孔を備えるガラス基板であって、

前記貫通孔の側面は、

前記第一面から距離０％以上１０％未満の範囲において、側面の角度は４°以上７°以下の範囲となり、断面視において、前記貫通孔の側面を左側面および右側面とした場合、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が１．０°以下であり、

前記第一面から距離１０％以上１００％以下の範囲において、側面の角度は－７°以上－１５°以下の範囲となり、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が１．０°以下となる、

ガラス基板。

（態様２）

態様１に記載のガラス基板であって、

前記貫通孔の側面は、前記第一面からの距離１％から距離５％以下の範囲に傾斜角度が変化する変曲点を有する、ガラス基板。

（態様３）

態様１または２に記載のガラス基板であって、

前記貫通孔では、第二面側の開口径 $\Phi 2$ と、第一面側の開口径 $\Phi 1$ の関係が、 $\Phi 1 / \Phi 2 \geq 0.4$ 以上となる、ガラス基板。

（態様４）

請求項１から３のいずれか１つに記載のガラス基板であって、

前記ガラス基板の厚さ方向における前記貫通孔の裁断面における側面形状の

分散粗さが1,000nm以下かつ凹凸巾が1,500nm以下であることを特徴とするガラス基板。

(態様5)

態様1から4のいずれか1つに記載のガラス基板であって、

前記分散粗さは、前記側面の輪郭データに基づいて粗さ曲線を抽出し、前記粗さ曲線に設定区間を設定し、前記設定区間において式1によって算出された算術平均粗さであり、

前記凹凸巾は、前記設定区間において、最も高い部分と最も低い部の間の差である、ガラス基板。

[数1]

$$Ra = \frac{1}{L} \int_0^L |f(x)|^{(2)} dx \cdots \text{式 1}$$

Raは算術平均粗さ

f(x)は粗さ曲線

Lは設定区間の長さ

(態様6)

態様1から5のいずれか1つに記載のガラス基板であって、

前記ガラス基板のSiO₂比率は55質量%以上81質量%以下の範囲となる、ガラス基板。

(態様7)

態様1から6のいずれか1つに記載のガラス基板を含む多層配線基板であって、

前記多層配線基板に搭載される電子デバイスの層厚は800μm以下であり、

前記多層配線基板の厚みは100μm以上かつ400μm以下となる、ことを特徴とする多層配線基板。

(態様8)

態様 1 から 7 のいずれか 1 に記載のガラス基板の製造方法であって、
ガラス基板に対して、貫通孔形成予定部にレーザを照射する第 1 の工程、
レーザ照射された前記ガラス基板をエッチングし、貫通孔を形成する第 2
の工程

を有するガラス基板の製造方法。

(態様 9)

態様 8 に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第 2 の工程は、レーザ照射された前記ガラス基板をエッチング液中に
浸漬し、前記エッチング液において噴流の方向を切り替えるエッチング処理
を行い、貫通孔を形成する工程である、ガラス基板の製造方法。

(態様 10)

態様 8 または 9 に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第 2 の工程は、レーザ照射された前記ガラス基板にエッチング液を噴
射し、前記ガラス基板または前記エッチング液の噴射口のいずれかを揺動さ
せるエッチング処理を行い、貫通孔を形成する工程である、ガラス基板の製
造方法。

(態様 11)

態様 8 から 10 のいずれか 1 つに記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第 1 の工程において、照射されるレーザは、レーザ発振波長が 106
4 nm、532 nm、または 355 nm のうちのいずれかの波長でありかつ
パルス幅が 25 ピコ秒以下である、ガラス基板の製造方法。

(態様 12)

態様 8 から 11 のいずれか 1 つに記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第 1 の工程において、前記レーザ照射周辺部に発生するマイクロクラ
ックの最大長さが 5 μ m である、ガラス基板の製造方法。

(態様 13)

態様 8 から 12 のいずれか 1 つに記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第 2 の工程において、フッ酸を 0.2 質量%以上 20.0 質量%以下

の範囲とし、硝酸を4.0質量%以上25.0質量%以下の範囲とし、フッ酸および硝酸以外の無機酸を0.5質量%以上11.0質量%以下の範囲として含有するエッチング液が用いられる、ガラス基板の製造方法。

符号の説明

[0084] 1：多層配線基板、10：ガラス基板、11：貫通電極、12：貫通孔、21：第一配線層、22：第二配線層、25：絶縁樹脂層、31：導通電極、50：半導体素子用接合パッド、54：基板用接合パッド、61：第一接着層、62：第一支持体、63：積層構造体、65：レーザ改質部、70：第二支持体、71：第二接着層、90：BGA基板、100：半導体素子、101：ガラス基板10の第一面、102：ガラス基板10の第二面、TC：貫通孔の中心線、ss：貫通孔の側面との接線

請求の範囲

- [請求項1] 第一面と第二面を有し、前記第一面から前記第二面まで貫通する少なくとも1つの貫通孔を備えるガラス基板であって、
前記貫通孔の側面は、
前記第一面から距離0%以上10%未満の範囲において、側面の角度は 4° 以上 7° 以下の範囲となり、断面視において、前記貫通孔の側面を左側面および右側面とした場合、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が 1.0° 以下であり、
前記第一面から距離10%以上100%以下の範囲において、側面の角度は -7° 以上 -15° 以下の範囲となり、左側面の傾斜角度と右側面の傾斜角度の差が 1.0° 以下となる、
ガラス基板。
- [請求項2] 請求項1に記載のガラス基板であって、
前記貫通孔の側面は、前記第一面からの距離1%から距離5%以下の範囲に傾斜角度が変化する変曲点を有する、ガラス基板。
- [請求項3] 請求項1に記載のガラス基板であって、
前記貫通孔では、第二面側の開口径 $\Phi 2$ と、第一面側の開口径 $\Phi 1$ の関係が、 $\Phi 1 / \Phi 2 \geq 0.4$ 以上となる、ガラス基板。
- [請求項4] 請求項1に記載のガラス基板であって、
前記ガラス基板の厚さ方向における前記貫通孔の裁断面における側面形状の
分散粗さが $1,000\text{ nm}$ 以下かつ凹凸巾が $1,500\text{ nm}$ 以下である、ことを特徴とするガラス基板。
- [請求項5] 請求項4に記載のガラス基板であって、
前記分散粗さは、前記側面の輪郭データに基づいて粗さ曲線を抽出し、前記粗さ曲線に設定区間を設定し、前記設定区間において式1によって算出された算術平均粗さであり、
前記凹凸巾は、前記設定区間において、最も高い部分と最も低い部

の間の差である、ガラス基板。

[数1]

$$Ra = \frac{1}{L} \int_0^L |f(x)|^{(2)} dx \cdots \text{式 1}$$

Ra は算術平均粗さ

f (x) は粗さ曲線

L は設定区間の長さ

[請求項6] 請求項1から3のいずれか1項に記載のガラス基板であって、
前記ガラス基板のSiO₂比率は55質量%以上81質量%以下の
範囲となる、ガラス基板。

[請求項7] 請求項1から3のいずれか1項に記載のガラス基板を含む多層配線
基板であって、
前記多層配線基板に搭載される電子デバイスの層厚は800μm以
下であり、
前記多層配線基板の厚みは100μm以上かつ400μm以下とな
る、ことを特徴とする多層配線基板。

[請求項8] 請求項1に記載のガラス基板の製造方法であって、
ガラス基板に対して、貫通孔形成予定部にレーザを照射する第1の
工程、
レーザ照射された前記ガラス基板をエッチングし、貫通孔を形成す
る第2の工程
を有するガラス基板の製造方法。

[請求項9] 請求項8に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第2の工程は、レーザ照射された前記ガラス基板をエッチング
液中に浸漬し、前記エッチング液において噴流の方向を切り替えるエ
ッチング処理を行い、貫通孔を形成する工程である、ガラス基板の製
造方法。

[請求項10] 請求項8に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第2の工程は、レーザ照射された前記ガラス基板にエッチング
液を噴射し、前記ガラス基板または前記エッチング液の噴射口のいず

れかを揺動させるエッチング処理を行い、貫通孔を形成する工程である、ガラス基板の製造方法。

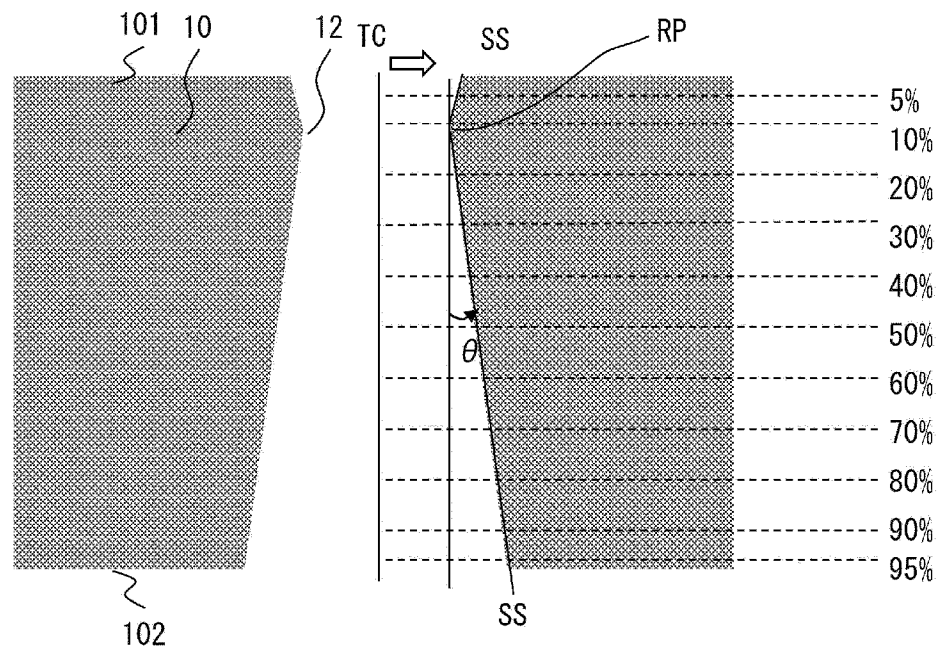
[請求項11] 請求項8に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第1の工程において、照射されるレーザは、レーザ発振波長が1064nm、532nm、または355nmのうちのいずれかの波長でありかつパルス幅が25ピコ秒以下である、ガラス基板の製造方法。

[請求項12] 請求項8に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第1の工程において、前記レーザ照射周辺部に発生するマイクロクラックの最大長さが5μmである、ガラス基板の製造方法。

[請求項13] 請求項8に記載のガラス基板の製造方法であって、
前記第2の工程において、フッ酸を0.2質量%以上20.0質量%以下の範囲とし、硝酸を4.0質量%以上25.0質量%以下の範囲とし、フッ酸および硝酸以外の無機酸を0.5質量%以上11.0質量%以下の範囲として含有するエッチング液が用いられる、ガラス基板の製造方法。

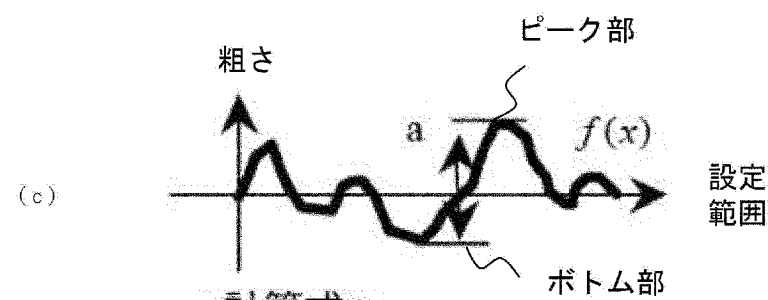
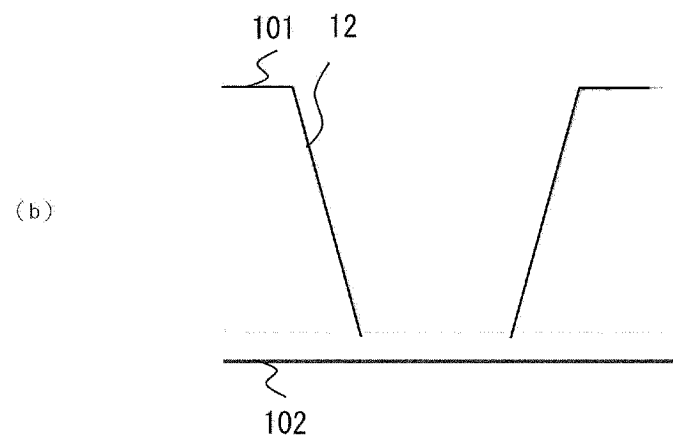
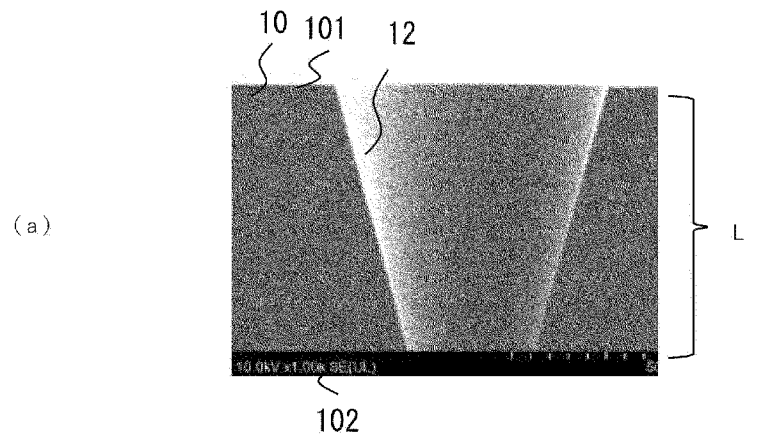
[図1]

図 1



[図2]

図 2



<計算式>

平均粗さ、(平均分散粗さ)

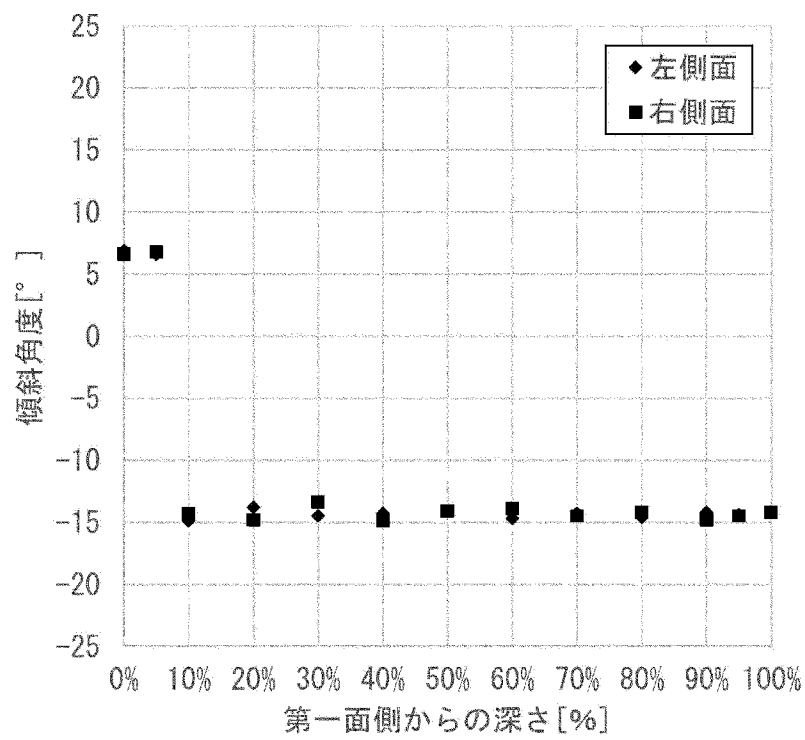
$$R_a = \frac{1}{L} \int_0^L |f(x)| dx \quad \dots \text{式 (1)}$$

L 設定領域の長さ

ラフネス幅: a

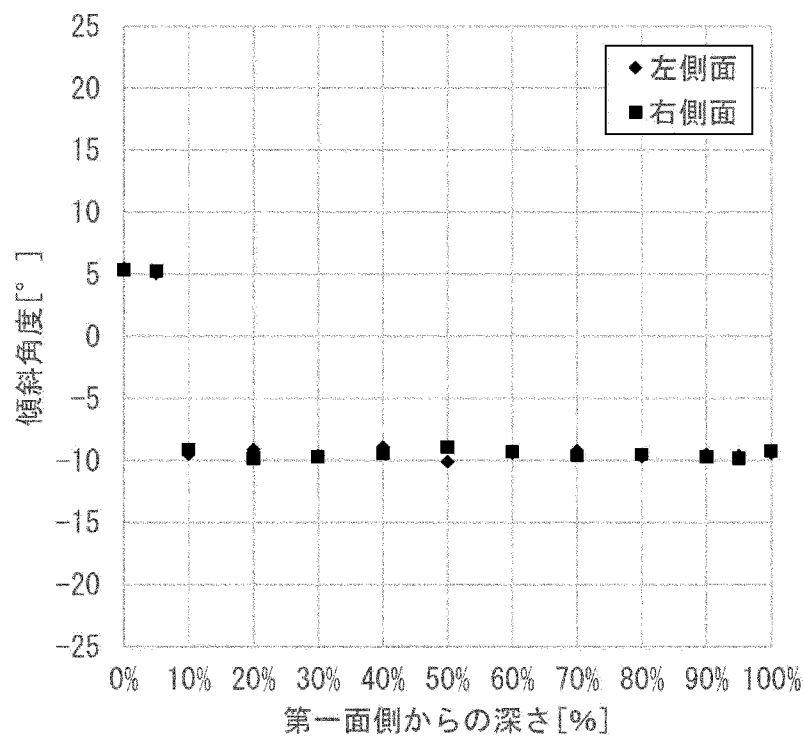
[図3]

図 3



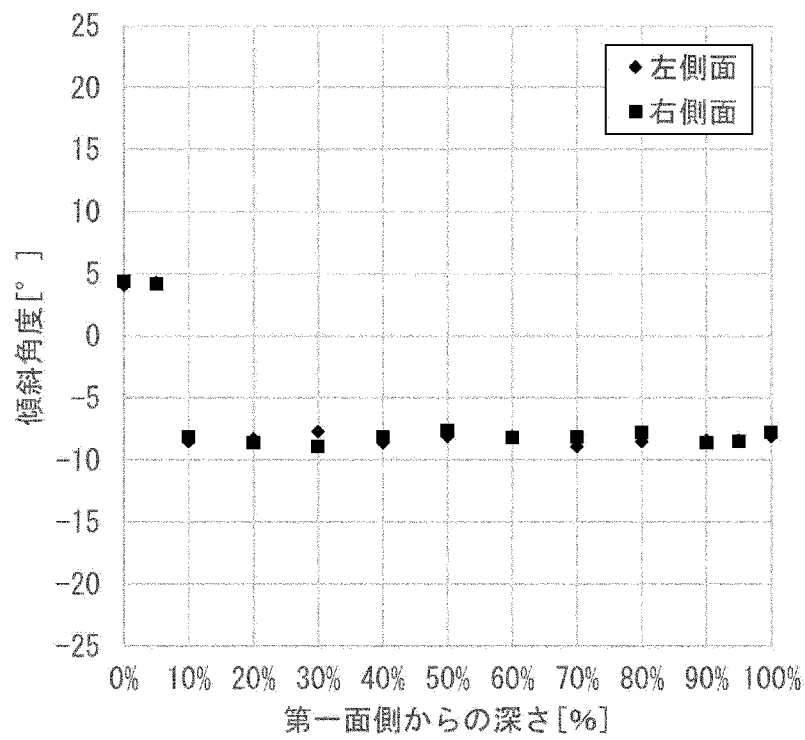
[図4]

図 4



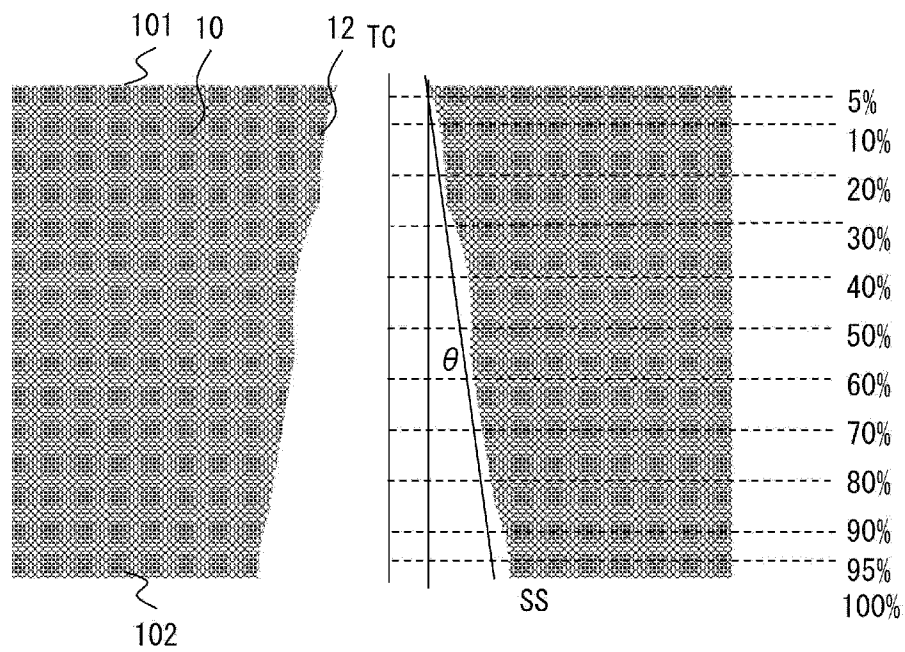
[図5]

図 5



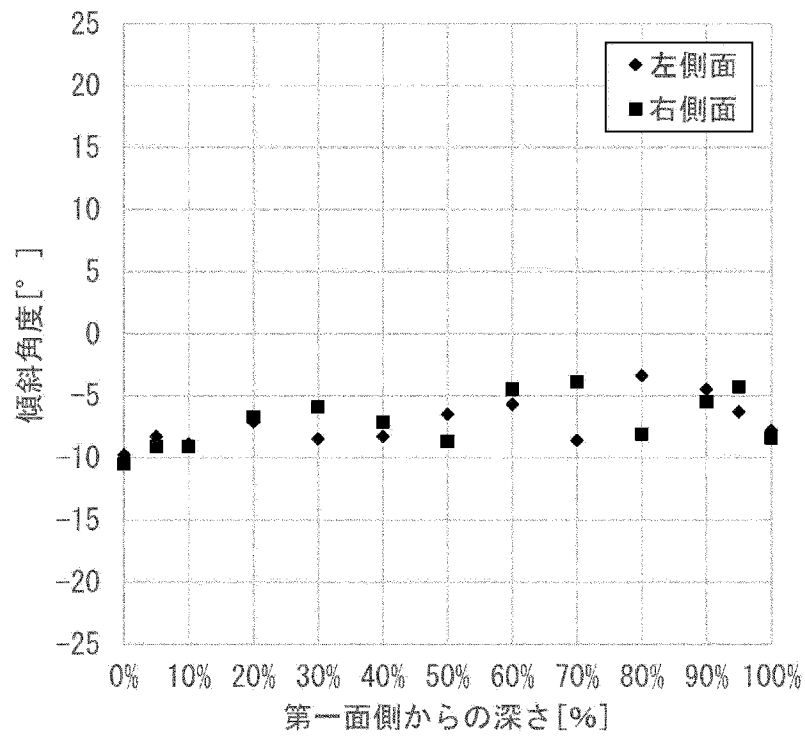
[図6]

図 6



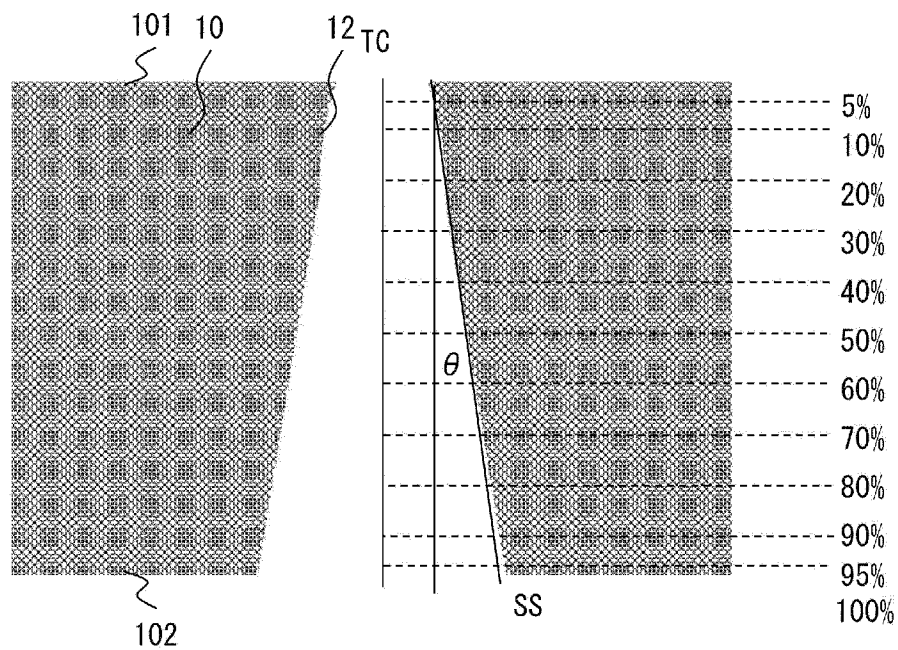
[図7]

図 7



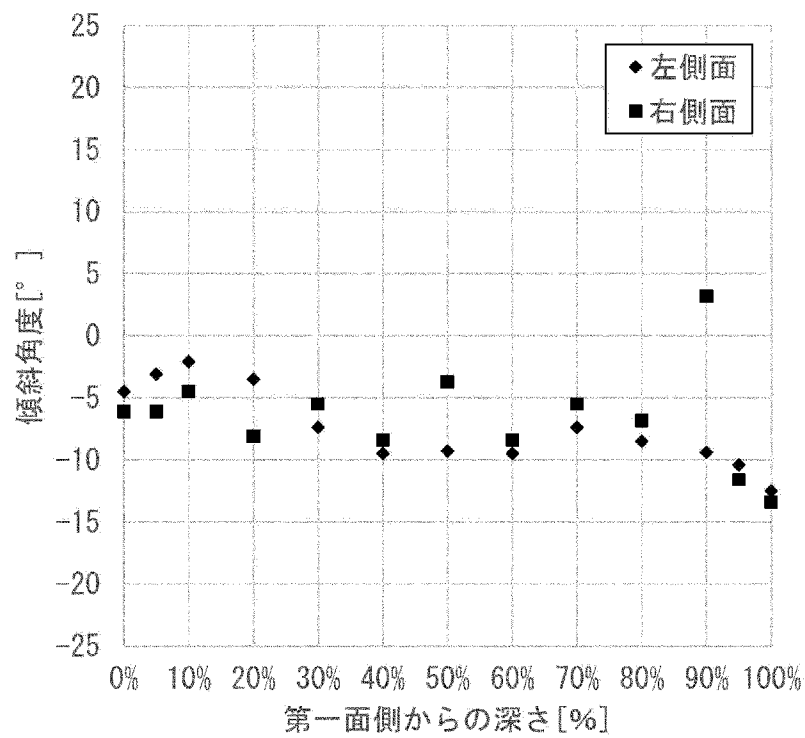
[図8]

図 8



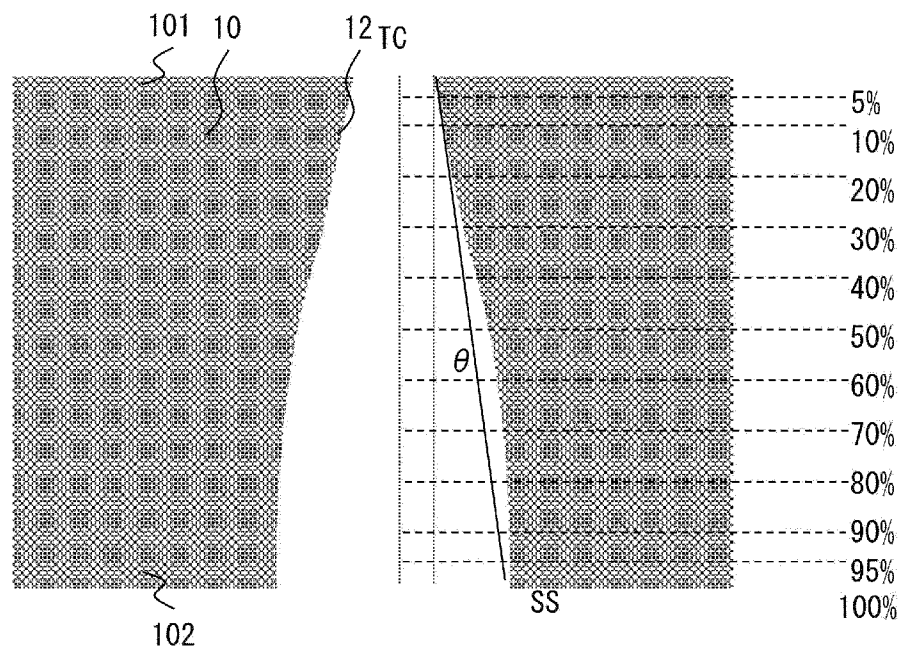
[図9]

図 9



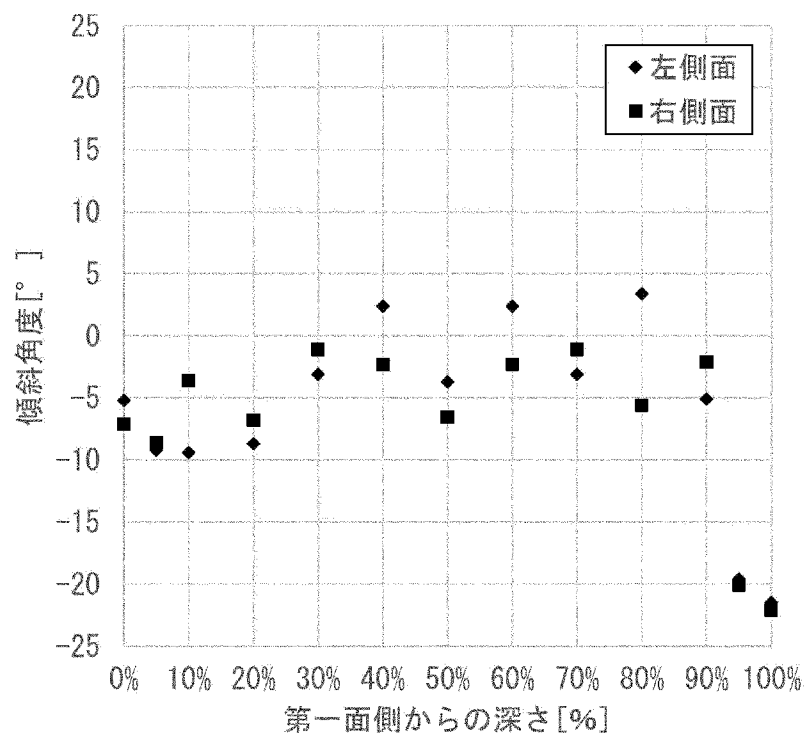
[図10]

図 10



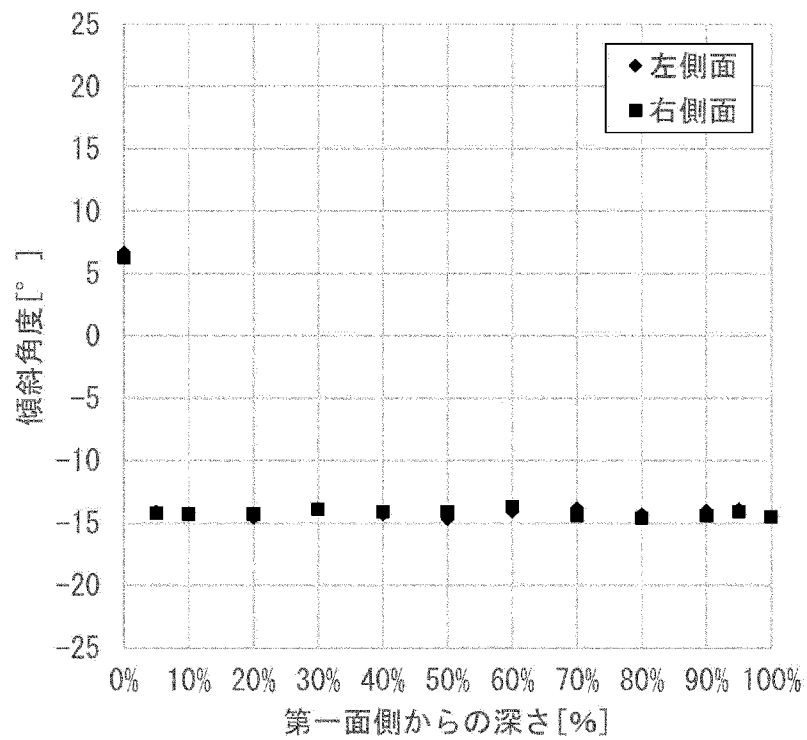
[図11]

図 1 1



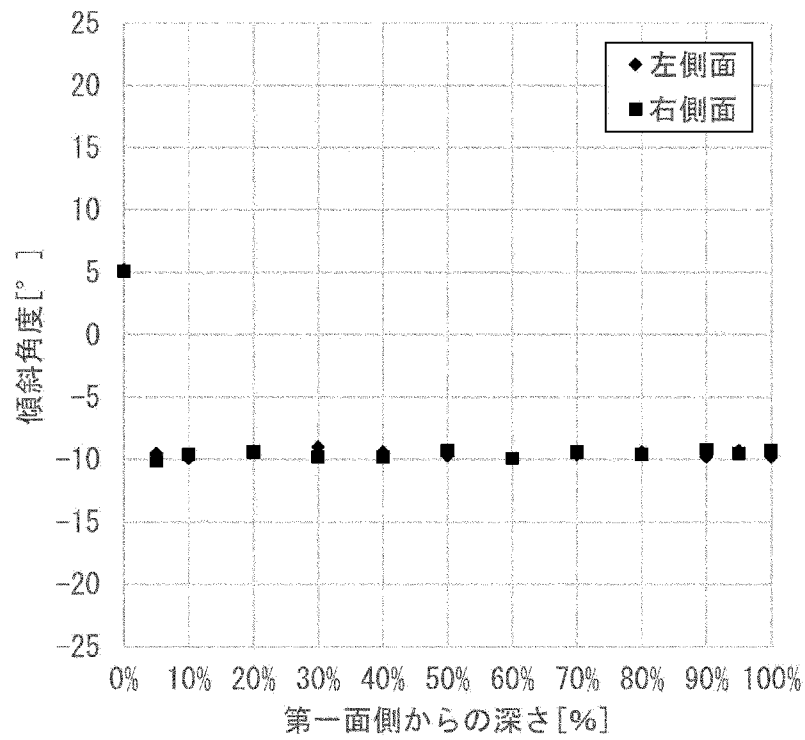
[図12]

図 1 2



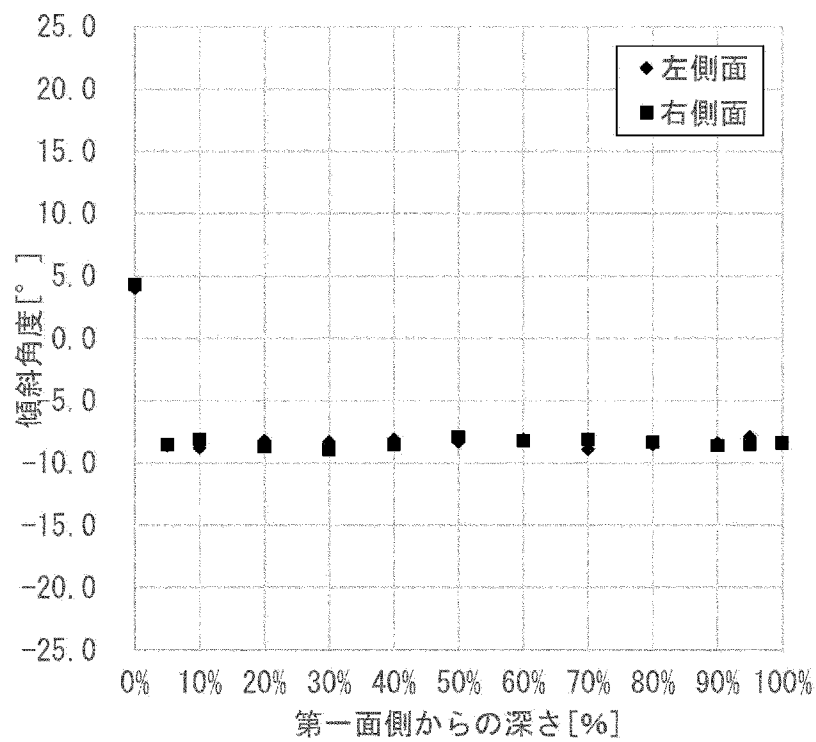
[図13]

図 1 3



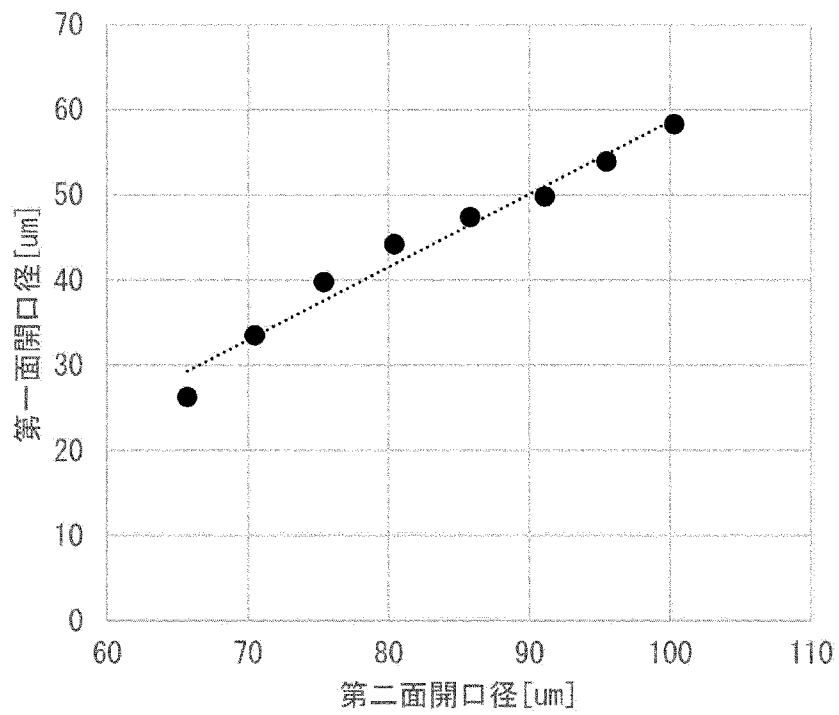
[図14]

図 1 4



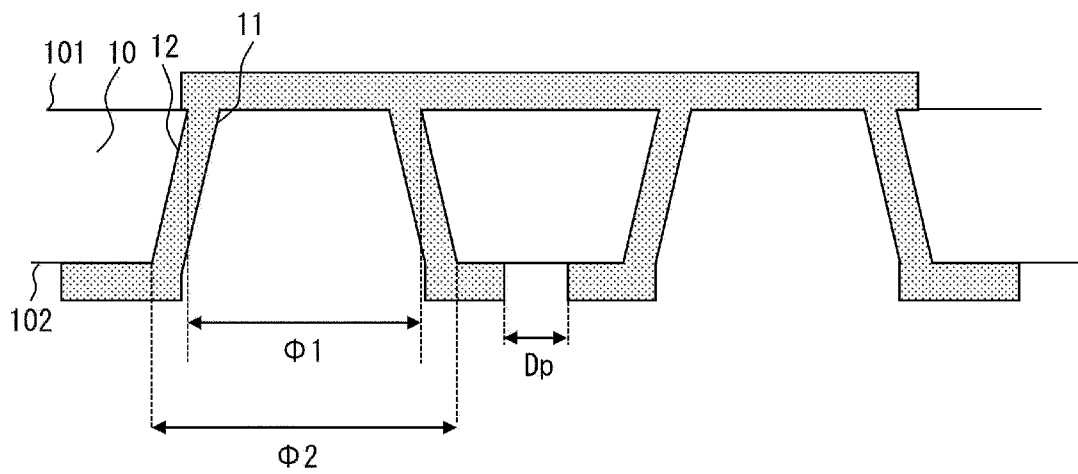
[図15A]

図 1 5 A



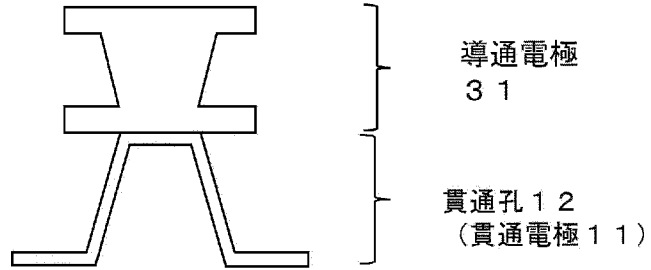
[図15B]

図 1 5 B



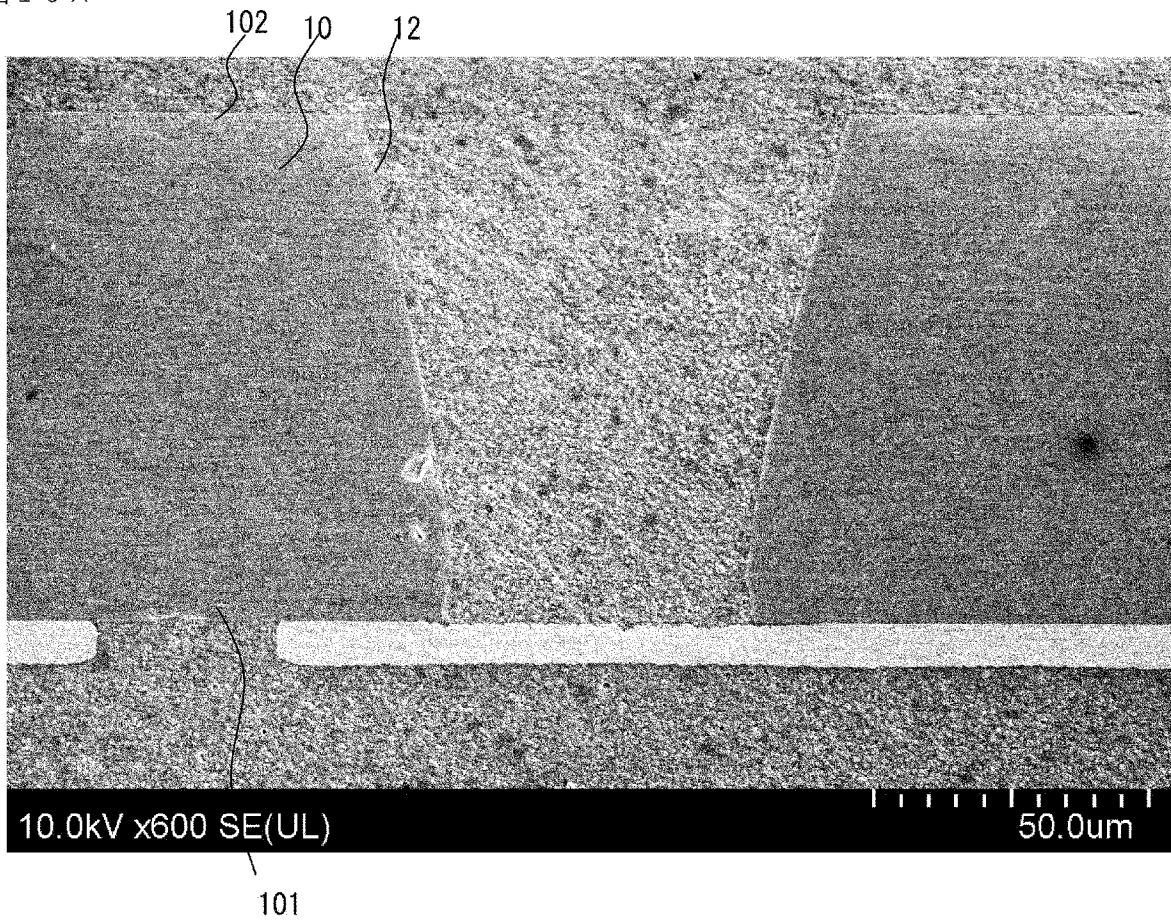
[図15C]

図 1 5 C



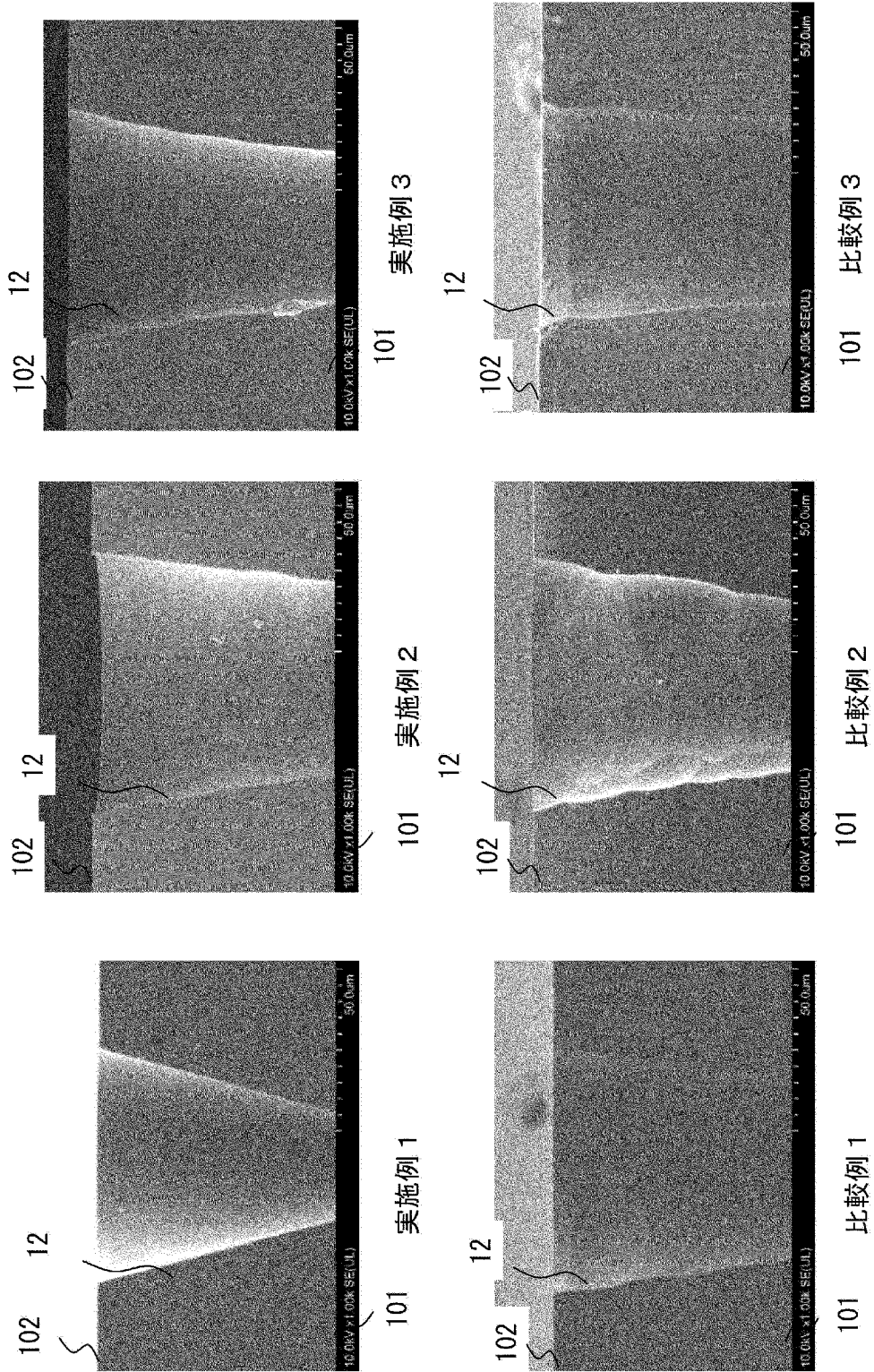
[図16A]

図16A



[図16B]

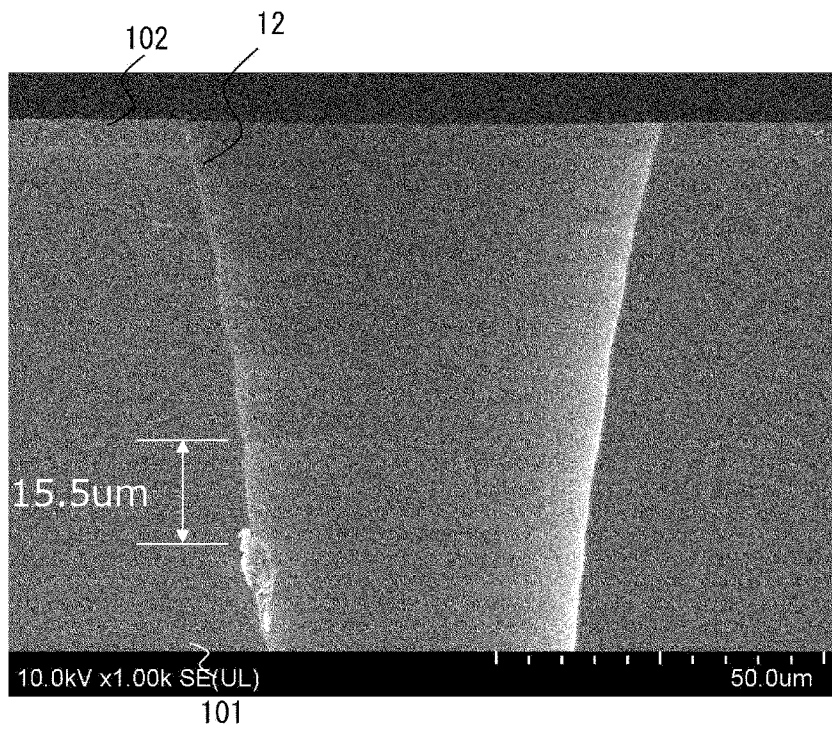
図 16 B



[図16C]

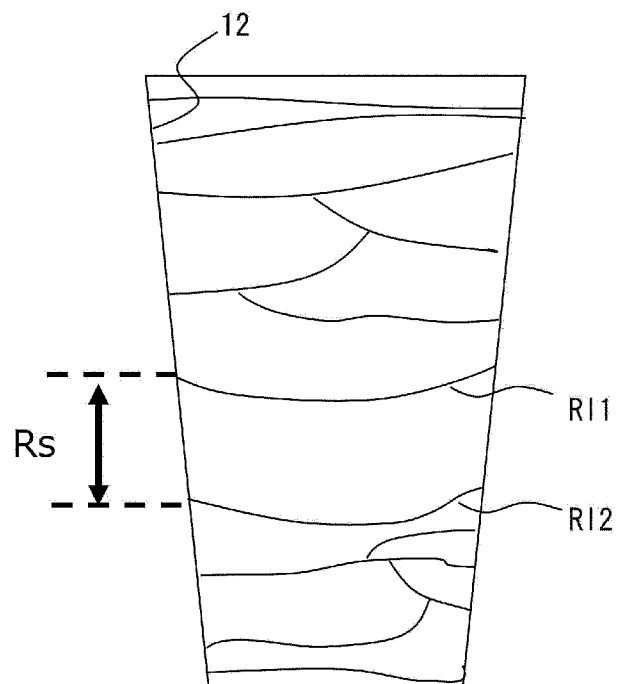
図16C

(a)



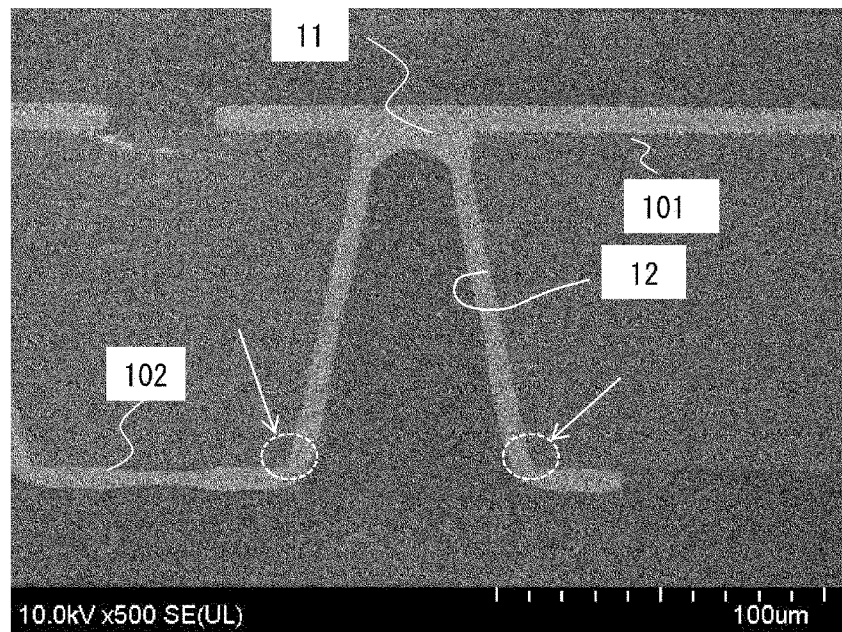
実施例3

(b)



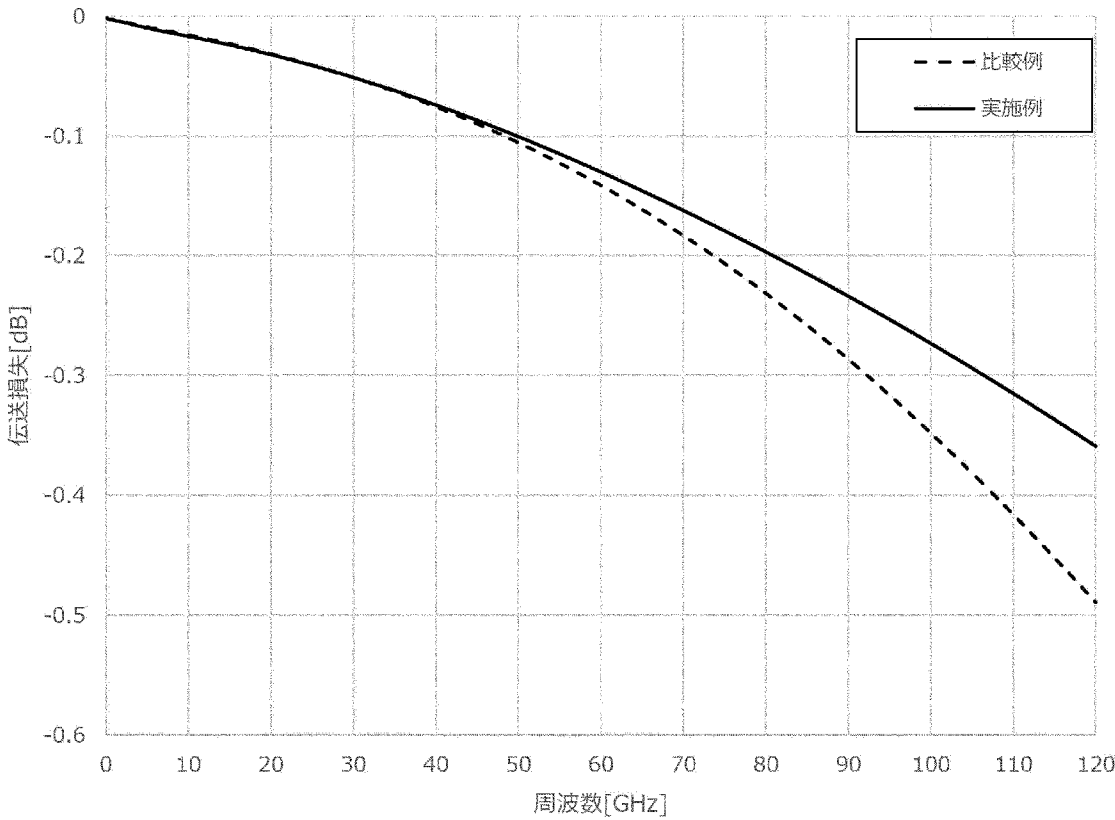
[図16D]

図 1 6 D



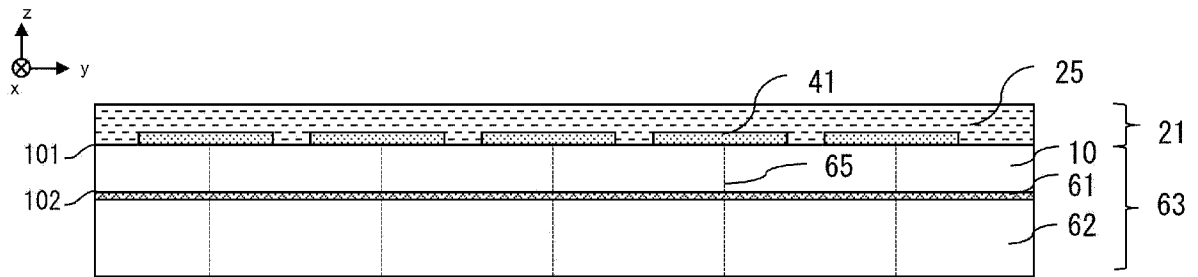
[図17]

図 1 7



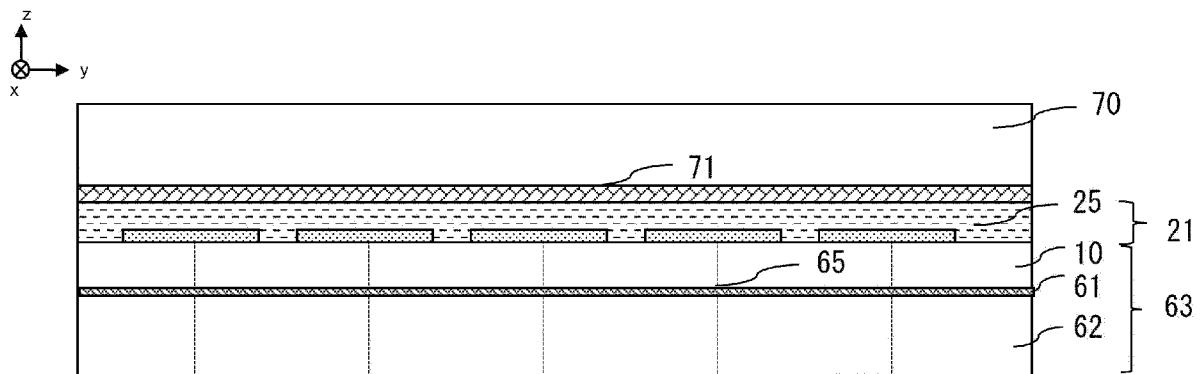
[図22]

図 2 2



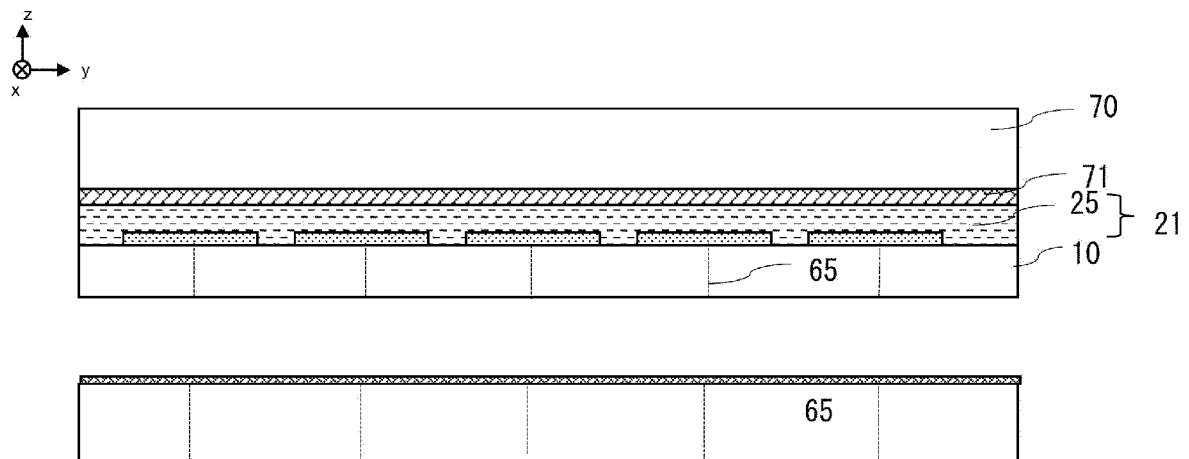
[図23]

図 2 3



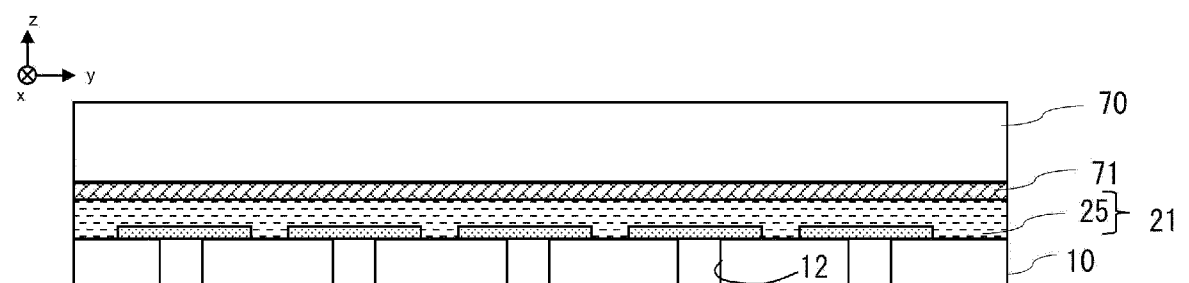
[図24]

図 2 4



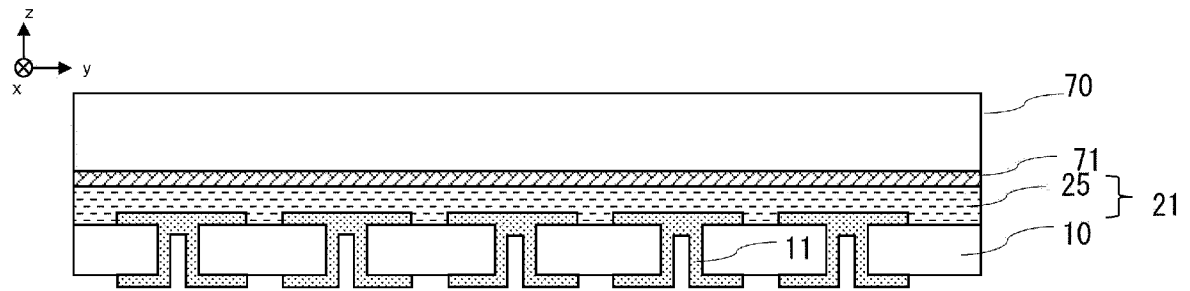
[図25]

図 2 5



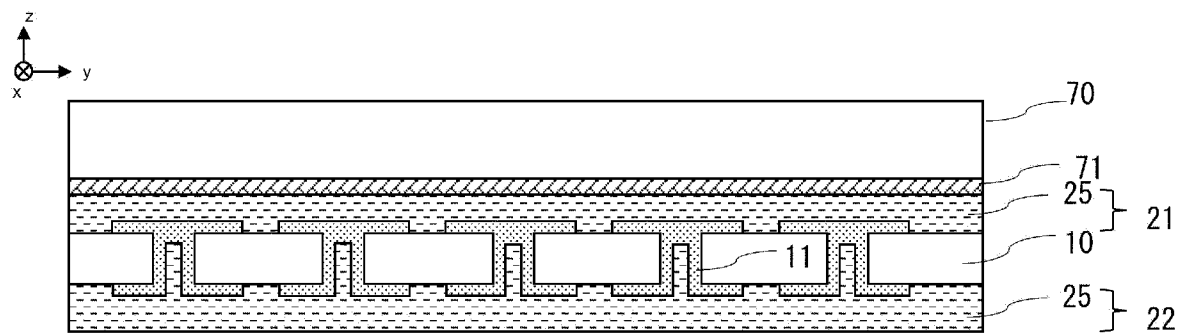
[図26]

図 2 6



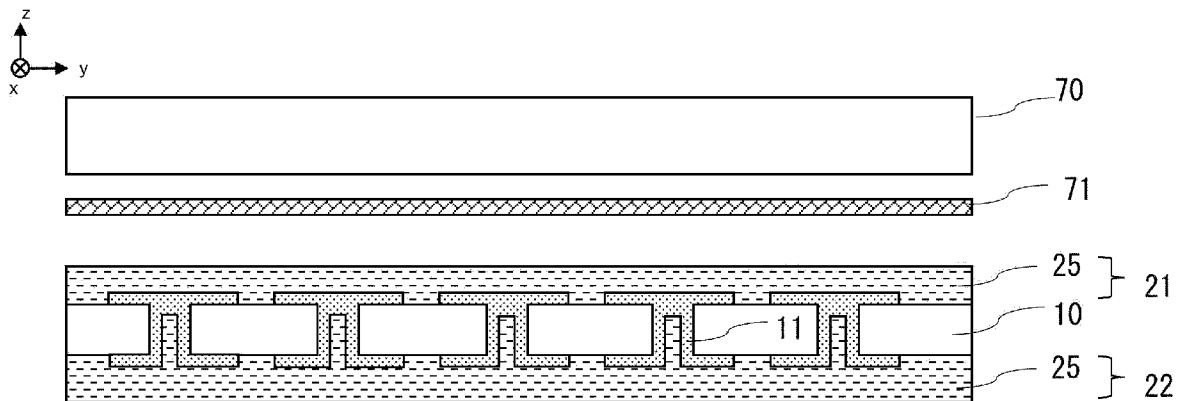
[図27]

図 2 7



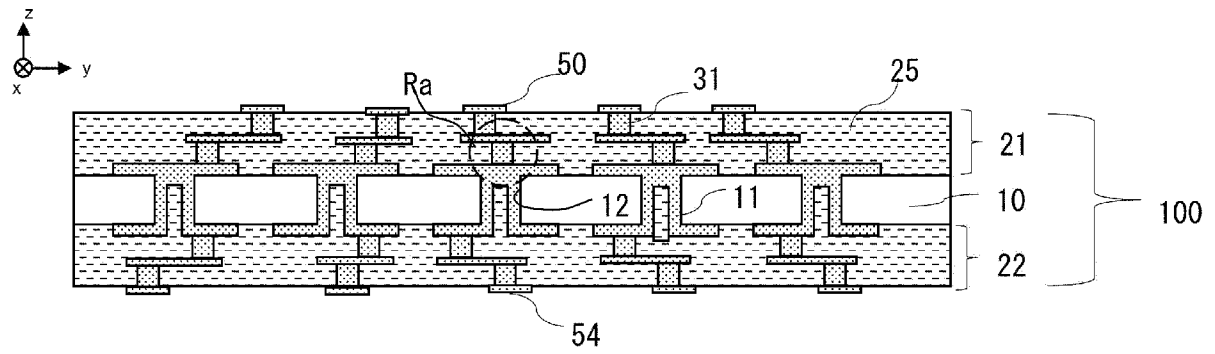
[図28]

図 2 8



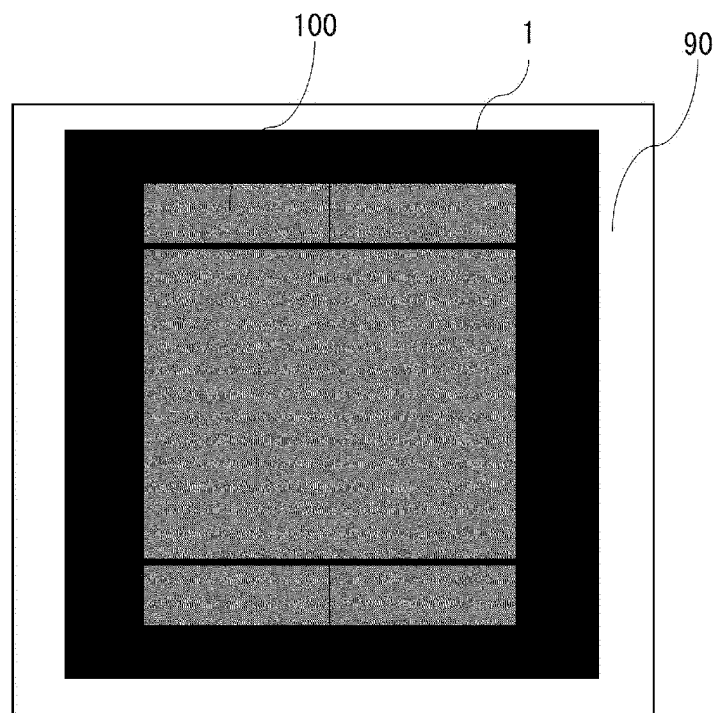
[図29]

図 29



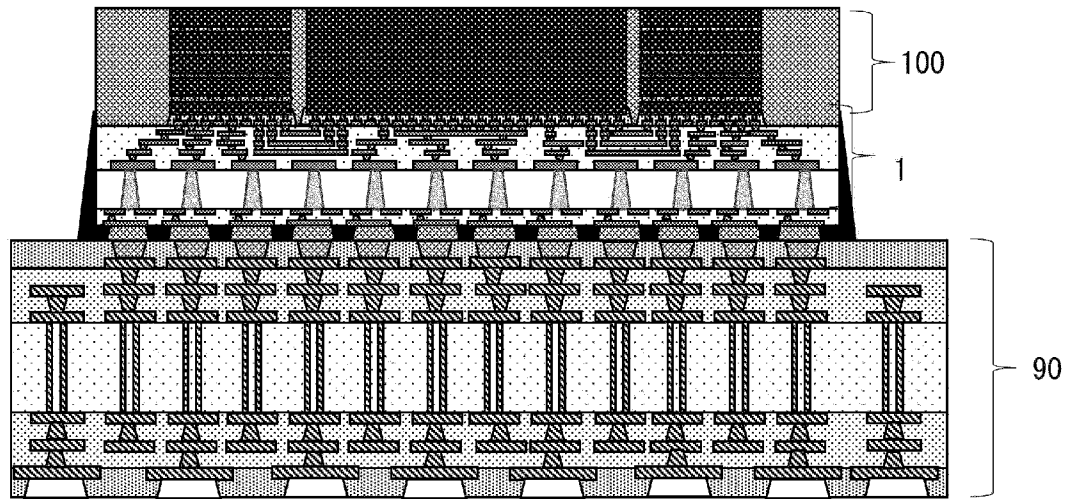
[図30]

図 30



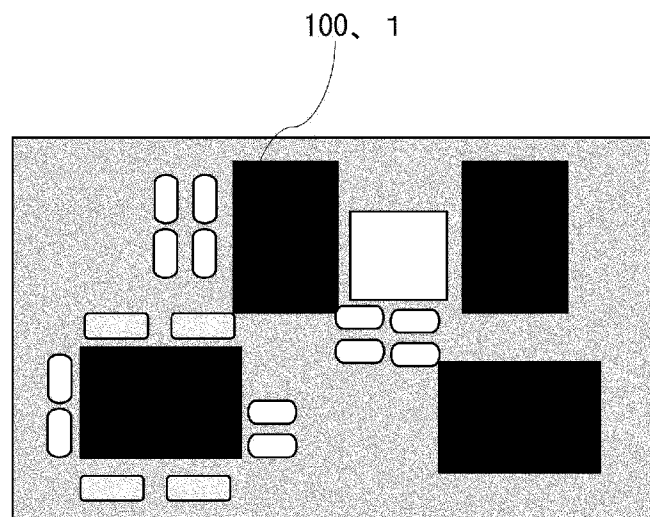
[図31]

図3 1



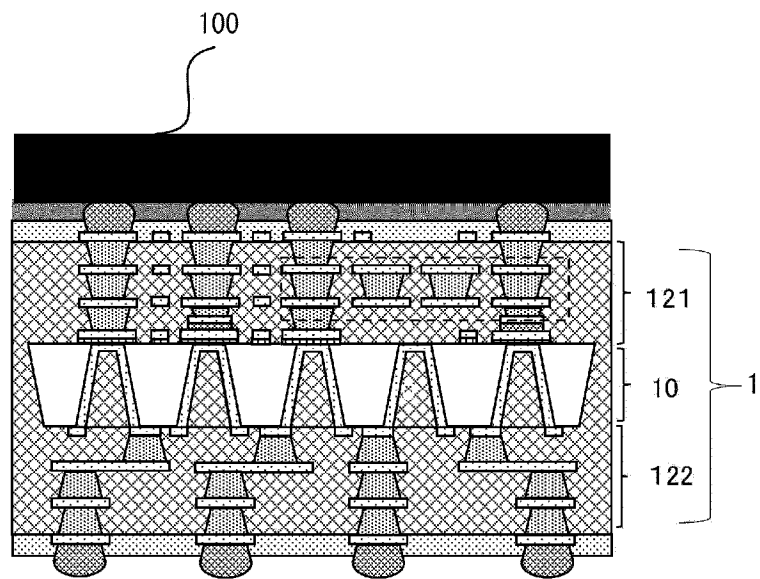
[図32]

図3 2



[図33]

図 3 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/029924

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**H01L 23/15**(2006.01)i; **H01L 23/12**(2006.01)i; **H05K 3/46**(2006.01)i

FI: H01L23/14 C; H05K3/46 N; H05K3/46 Q; H01L23/12 N

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01L23/15; H01L23/12; H05K3/46

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2023

Registered utility model specifications of Japan 1996-2023

Published registered utility model applications of Japan 1994-2023

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2020-521335 A (CORNING INCORPORATED) 16 July 2020 (2020-07-16) entire text, all drawings	1-13
A	JP 2015-146410 A (DAINIPPON PRINTING CO LTD) 13 August 2015 (2015-08-13) entire text, all drawings	1-13



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 October 2023

Date of mailing of the international search report

31 October 2023

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)

3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915

Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2023/029924

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP	2020-521335	A	16 July 2020	US 2018/0342450 A1	
				entire text, all drawings	
				WO 2018/217696 A2	
				CN 110709987 A	
				KR 10-2020-0010478 A	
				(Family: none)	
JP	2015-146410	A	13 August 2015		

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） H01L 23/15(2006.01)i; H01L 23/12(2006.01)i; H05K 3/46(2006.01)i FI: H01L23/14 C; H05K3/46 N; H05K3/46 Q; H01L23/12 N										
B. 調査を行った分野										
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） H01L23/15; H01L23/12; H05K3/46										
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2023年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2023年</td> </tr> </table>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年
日本国実用新案公報	1922 - 1996年									
日本国公開実用新案公報	1971 - 2023年									
日本国実用新案登録公報	1996 - 2023年									
日本国登録実用新案公報	1994 - 2023年									
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）										
C. 関連すると認められる文献										
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号								
A	JP 2020-521335 A（コーニング インコーポレイテッド）16.07.2020（2020 - 07 - 16） 全文、全図	1-13								
A	JP 2015-146410 A（大日本印刷株式会社）13.08.2015（2015 - 08 - 13） 全文、全図	1-13								
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。										
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 </td> <td> “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献						
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技术水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献									
国際調査を完了した日 19.10.2023	国際調査報告の発送日 31.10.2023									
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官） 豊島 洋介 5F 9850 電話番号 03-3581-1101 内線 3516									

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2023/029924

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2020-521335	A	16.07.2020	US 2018/0342450 A1 全文、全図 WO 2018/217696 A2 CN 110709987 A KR 10-2020-0010478 A	
JP	2015-146410	A	13.08.2015	(ファミリーなし)	